

2024年3月期(2023年4月～2024年3月) 決算説明資料

2024年5月10日

株式会社 KOKUSAI ELECTRIC

注意事項

本資料及び本資料にて提供される情報は企業情報等の提供のために作成されたものであり、国内外を問わず、当社の発行する株式その他有価証券の勧誘を構成するものではありません。

■ 将来見通しについて

本資料に記述されている当社グループの事業計画、将来予測などは、当社グループが作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、将来の結果や業績を保証するものではありません。さまざまな外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果は計画、予測と大きく異なる結果となる可能性があります。当社グループは、適用ある法令又は証券取引所の規則により要求される場合を除き、本資料に含まれるいかなる情報についても、今後生じる事象に基づき更新又は改訂する義務を負うものではありません。なお、当社グループの経営成績、財政状態、キャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があることを認識している主なリスクは、有価証券報告書に記載しております。

■ 為替リスクについて

当社グループにおける海外売上収益は高い水準で推移しております。また、当社グループの外貨建ての資産および負債の評価は為替相場の変動により影響を受けます。当社グループ製品の輸出売上は、ほとんどが円建てで行われておりますが、一部に外貨建売上および費用計上もあり、為替相場の変動により影響を受けることがあります。

■ 経営指標について

当社グループは、企業価値の向上に向けて経営成績の推移を把握するため、調整後営業利益、調整後当期(四半期)利益を重要な経営指標として位置付けております。調整の内容につきましては、決算短信をご参照ください。調整後営業利益、調整後当期(四半期)利益につきましては、同様または類似の名称を用いている他社の経営指標と内容が異なる場合があります、比較可能性がない場合があります。

■ 会計基準について

当社グループは2021年3月期より国際会計基準(IFRS)に基づいて連結財務諸表を作成しております。

■ 数字の処理について

本資料に記載された金額(一部を除く)は、億円未満を四捨五入しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。



2024年3月期連結決算概要

2024年3月期連結決算概要

- NANDを中心に一部の半導体デバイスメーカーの投資抑制が続いたものの、市況は底を打ったと認識。中国では成熟ノード向けの設備投資が活発化、世界各国でも先端品開発への投資継続。
- 当社24/3期は前期比で減収減益ながら、1Qを底に業績回復傾向が顕著。中長期的な需要増加に対応するため、積極投資を継続。

2025年3月期連結業績予想

- 半導体関連市況の回復傾向は持続、25/3期後半に世界各国で先端品への設備投資が回復し始めると想定。
- 装置・サービスのそれぞれが回復し、24/3期比で増収増益を予想。

今後の取り組み

- 半導体関連市況は回復傾向が続き、中長期的に大きな成長を遂げるとの見方に変更なし。
- 3D NANDで先行した技術的優位性をDRAMやLogicに展開。パワーデバイス向けも柱の一つへの成長をめざす。

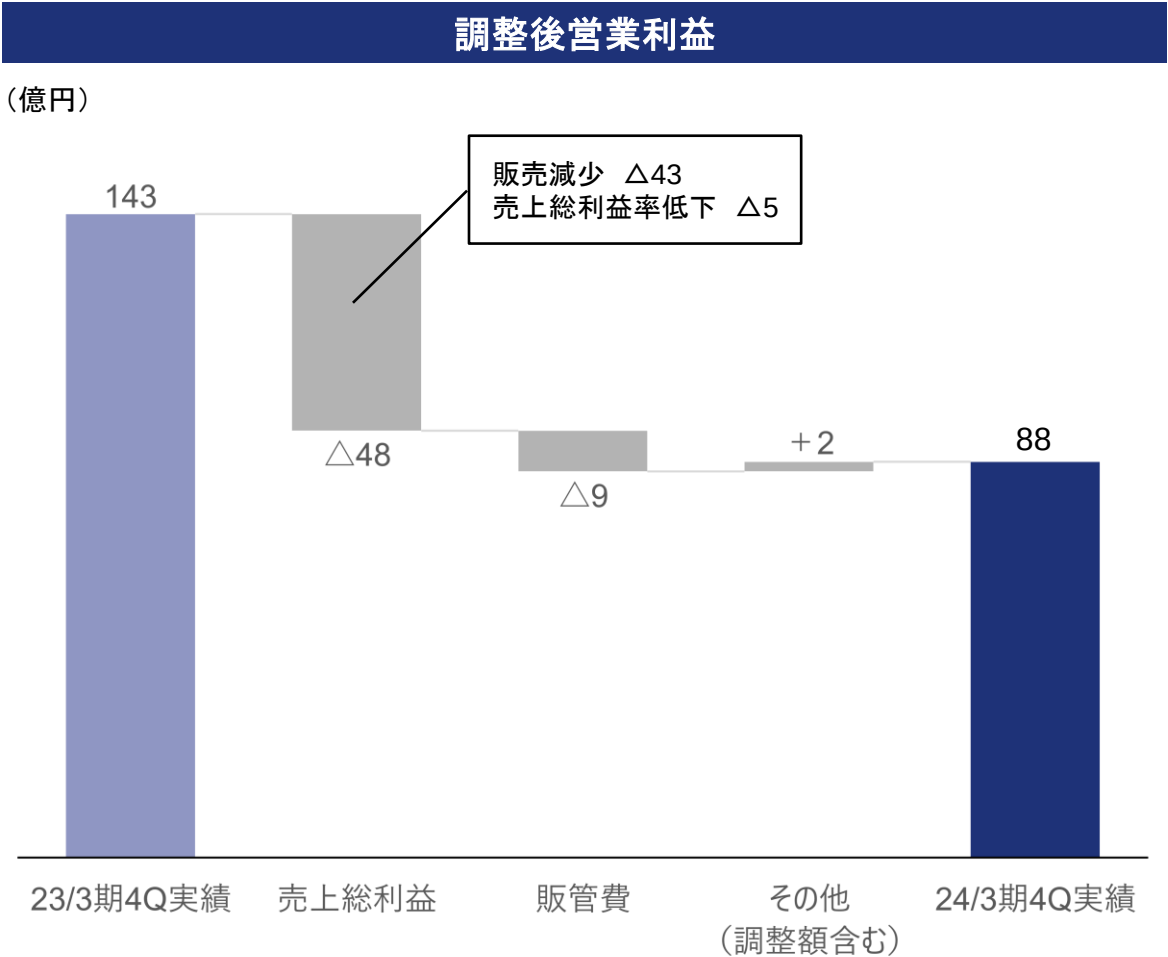
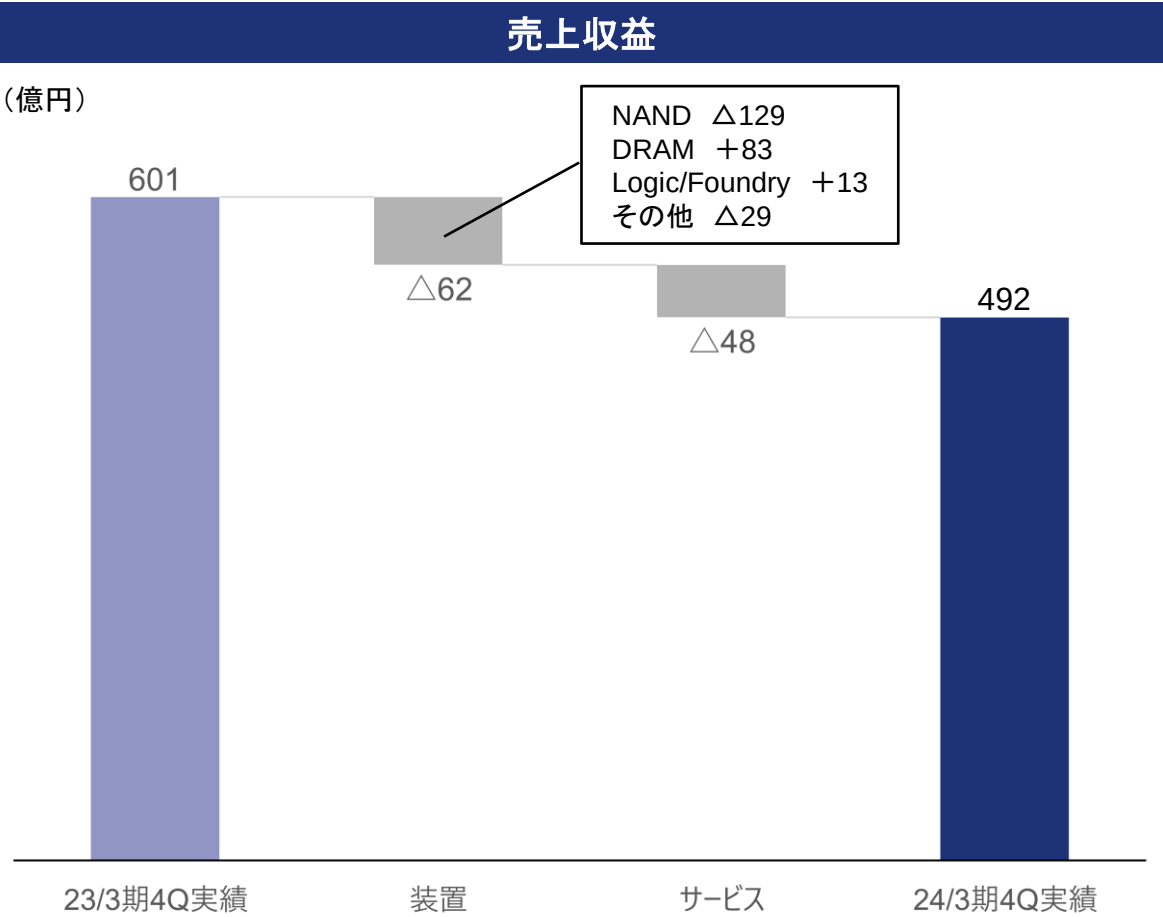
連結業績サマリー

通期業績は、NAND市況低迷の影響により前期比で減益減収ながら、2Qからの回復傾向を持続。
売上総利益率は、前期を上回る水準で着地。

(億円)	23/3期					24/3期							
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	前年同期比	通期	前期比	従来予想
売上収益	560	644	652	601	2,457	327	450	540	492	△18.2%	1,808	△26.4%	1,800
売上総利益	231	275	264	239	1,008	143	199	217	191	△20.1%	750	△25.6%	737
売上総利益率	41.2%	42.7%	40.4%	39.7%	41.0%	43.6%	44.2%	40.3%	38.8%	△1.0pts	41.5%	+0.4pts	40.9%
調整後営業利益	147	181	172	143	643	56	110	124	88	△38.5%	378	△41.1%	363
調整後営業利益率	26.2%	28.1%	26.3%	23.8%	26.1%	17.2%	24.5%	23.0%	17.9%	△5.9pts	20.9%	△5.2pts	20.1%
調整後当期(四半期)利益	108	125	122	105	460	38	73	91	71	△32.4%	273	△40.6%	252
調整後当期(四半期)利益率	19.3%	19.4%	18.7%	17.5%	18.7%	11.6%	16.2%	16.9%	14.5%	△3.1pts	15.1%	△3.6pts	14.0%
営業利益	130	164	155	111	561	40	94	107	67	△40.0%	307	△45.2%	291
営業利益率	23.2%	25.5%	23.8%	18.6%	22.8%	12.2%	20.9%	19.8%	13.6%	△5.0pts	17.0%	△5.8pts	16.2%
税引前当期(四半期)利益	129	164	157	109	559	37	91	107	61	△43.6%	298	△46.8%	283
税引前当期(四半期)利益率	23.0%	25.5%	24.0%	18.1%	22.7%	11.4%	20.3%	19.9%	12.5%	△5.6pts	16.5%	△6.3pts	15.7%
当期(四半期)利益	96	113	111	83	403	27	62	79	56	△32.3%	224	△44.5%	202
当期(四半期)利益率	17.1%	17.5%	17.0%	13.9%	16.4%	8.1%	13.7%	14.7%	11.5%	△2.4pts	12.4%	△4.0pts	10.2%
研究開発費	27	33	29	35	124	29	30	31	37	+3.8%	127	+2.1%	-
設備投資	7	29	22	8	66	51	21	105	28	3.4倍	205	3.1倍	-
減価償却費	25	26	26	26	103	26	27	28	28	+8.9%	109	+6.2%	-
1株当たり配当金(円)	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	11	-	11

2024年3月期第4四半期実績 増減要因

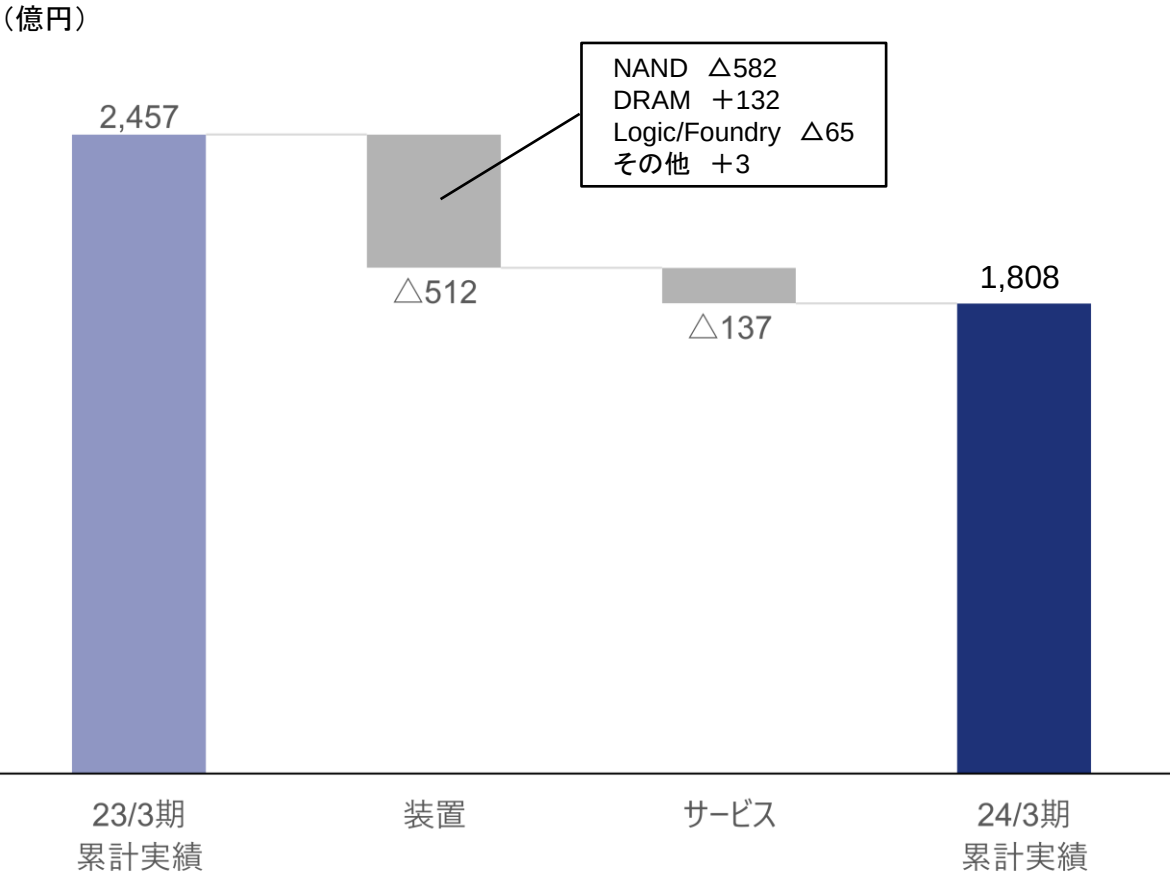
主にNANDに対する投資抑制により、売上収益は前年同期比▲109億円。
主に販売減少の影響により、調整後営業利益は前年同期比▲55億円。



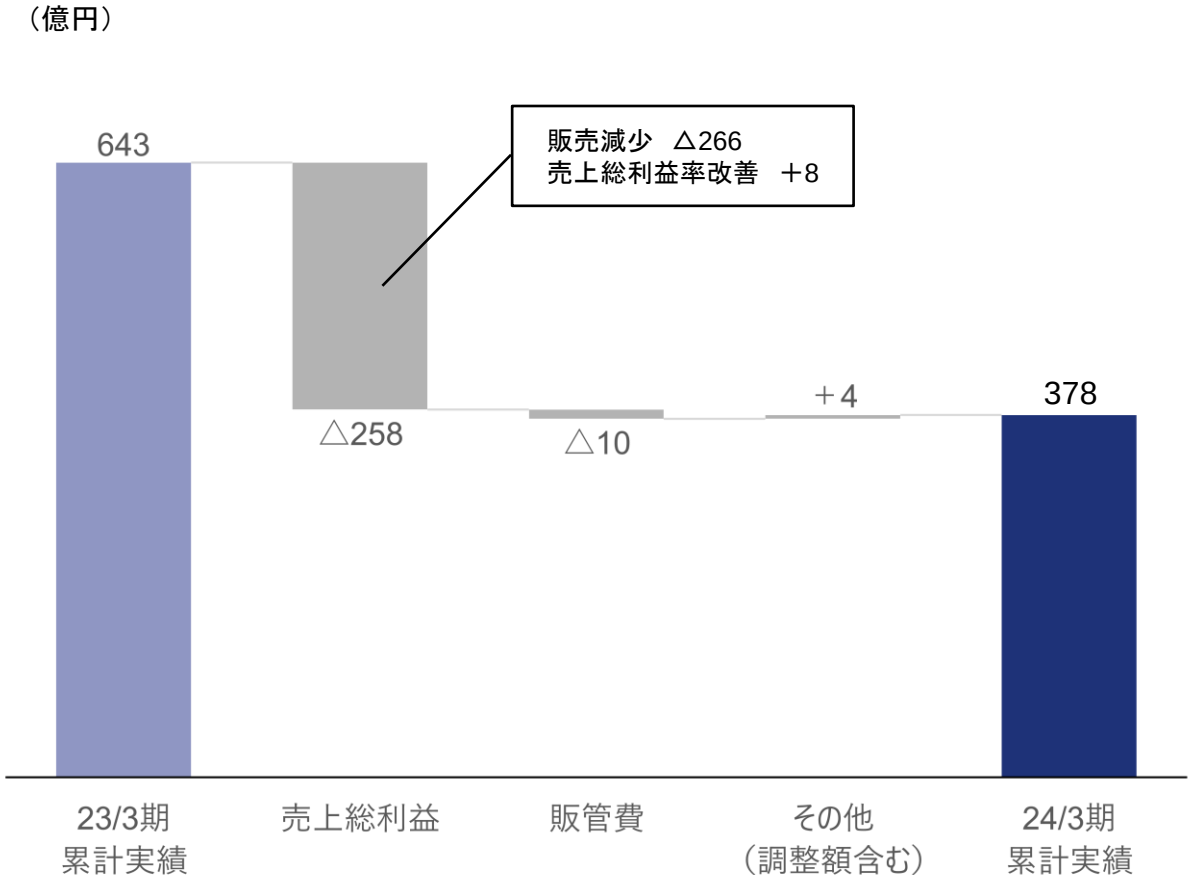
2024年3月期通期実績 増減要因

主にNANDに対する投資抑制により、売上収益は前期比▲649億円。
販売減少の影響を売上総利益率の改善が一部相殺し、調整後営業利益は前期比▲265億円。

売上収益

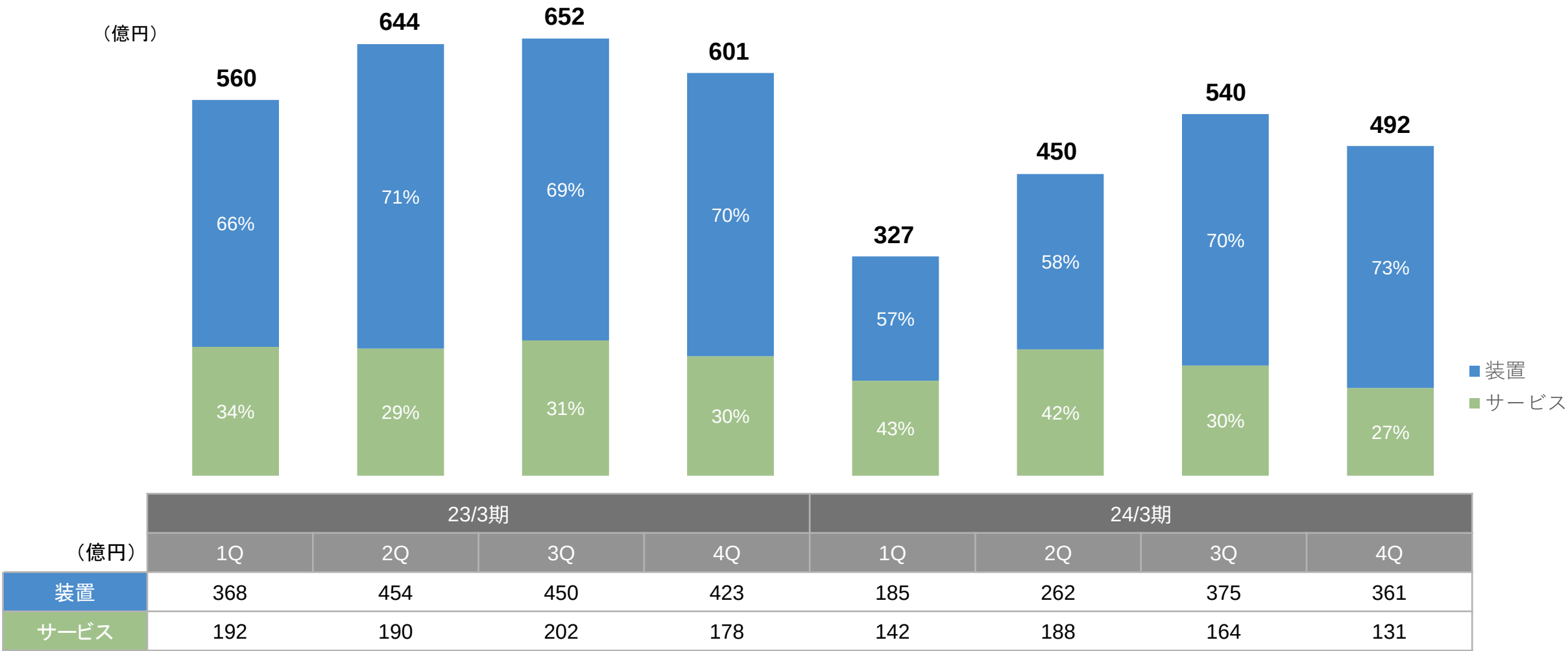


調整後営業利益



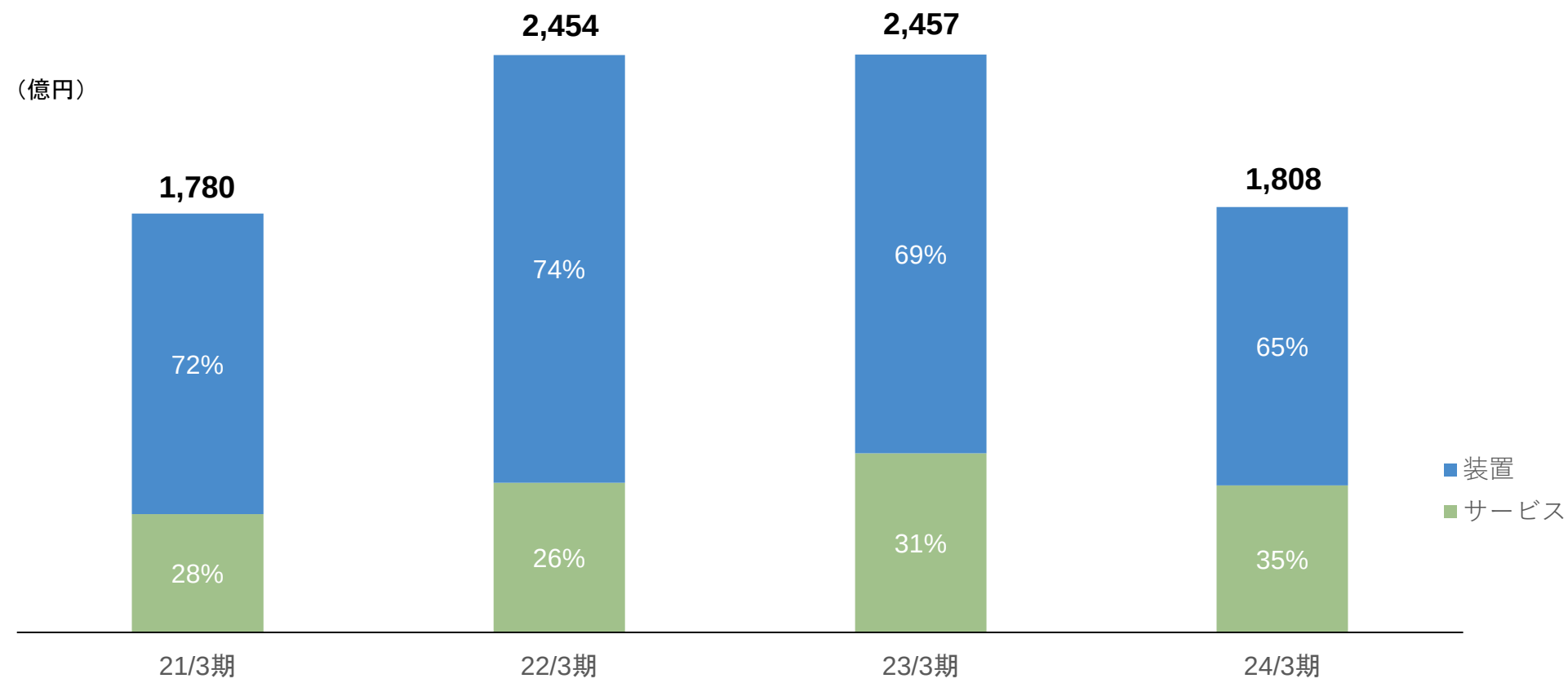
四半期別売上収益 ビジネス別

装置売上の回復により、3Qからの平常時の構成比を持続。



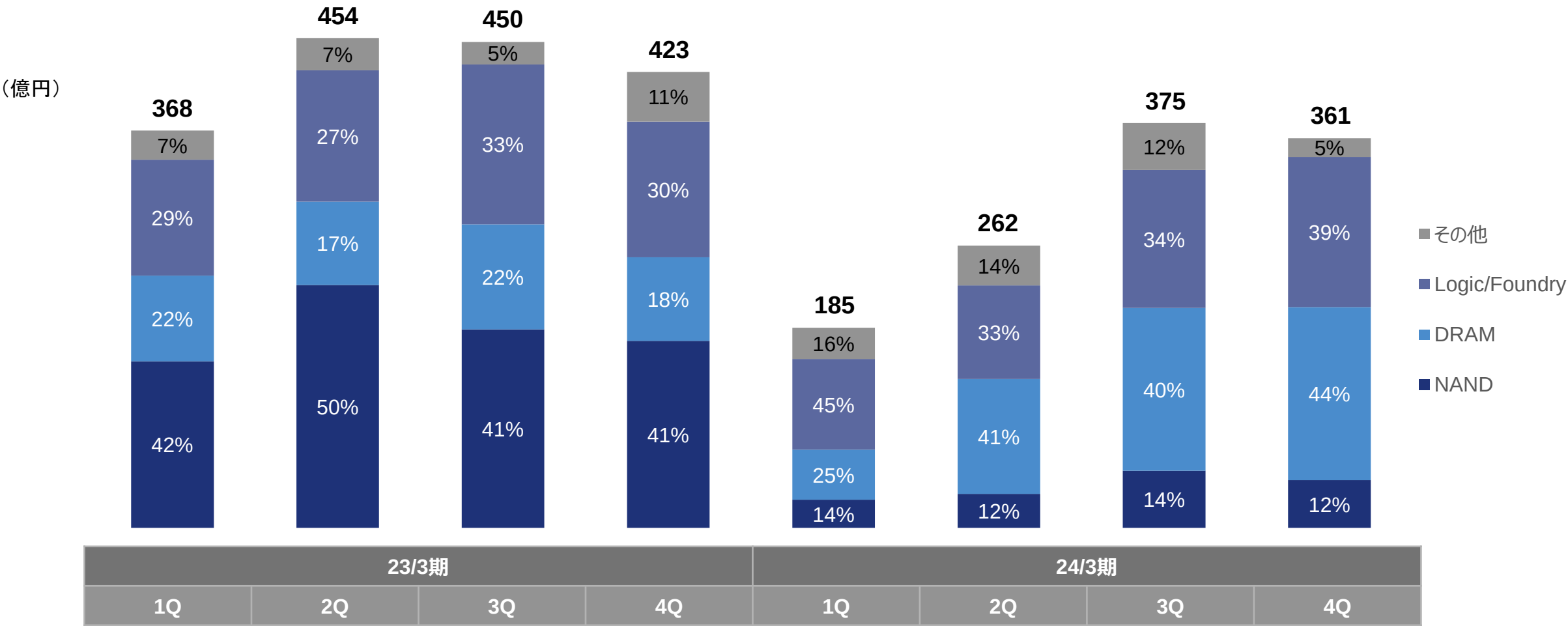
売上収益 ビジネス別

24/3期は、装置売上の減少により、サービスビジネスの比率が拡大。



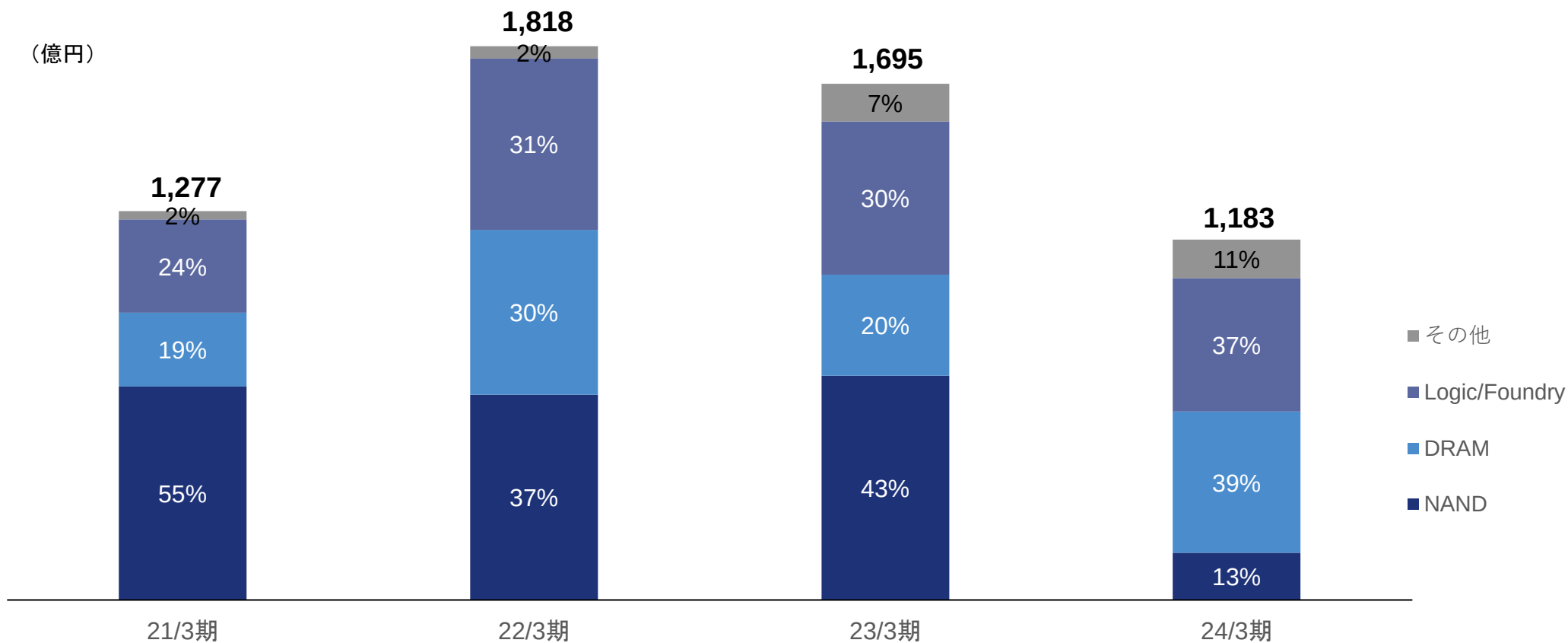
四半期別売上収益(300mm装置のみ) アプリケーション別

4Qは、NANDへの投資抑制が続く中、成熟ノードを含むDRAM、Logic/Foundryへの投資が堅調で、
NAND:DRAM:Logic/Foundry+その他=12%:44%:44%。



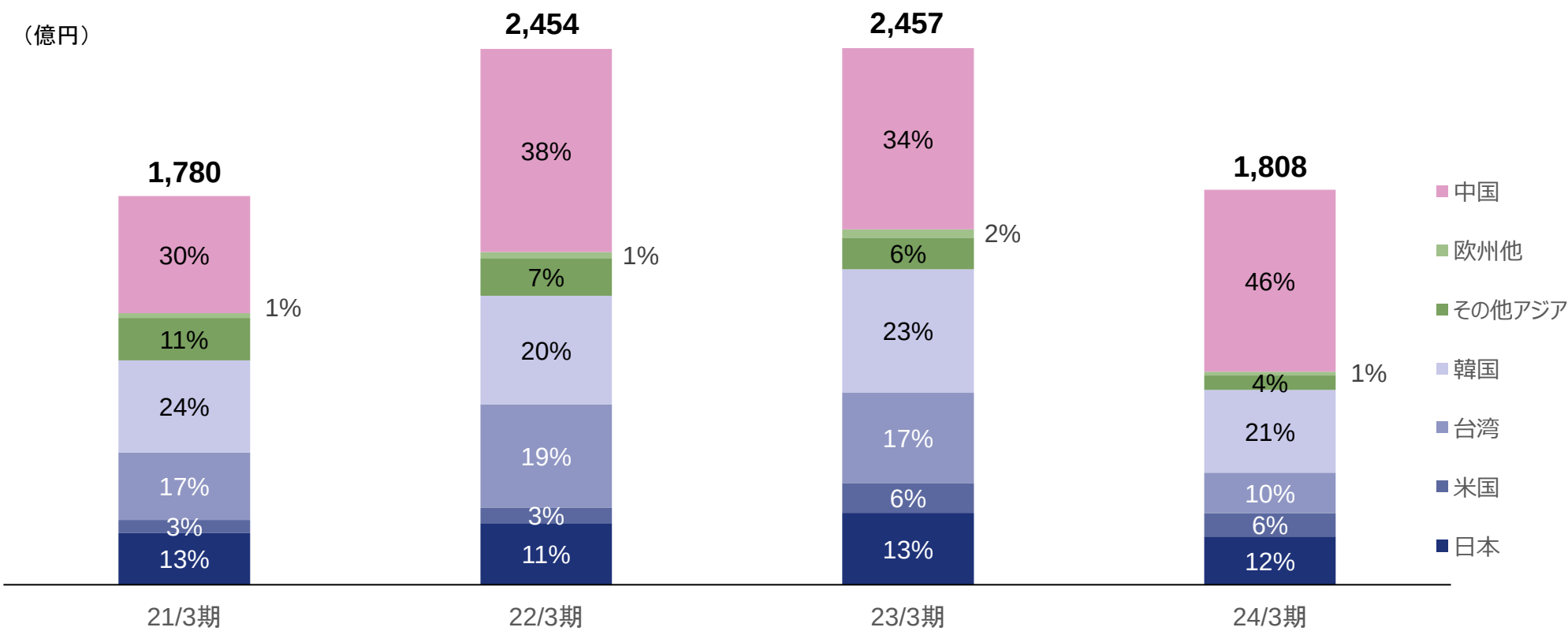
売上収益(300mm装置のみ) アプリケーション別

24/3期は、NANDへの投資抑制が影響する中、成熟ノードを含むDRAM、Logic/Foundry向けは例年並みの売上を維持し、DRAMとLogic/Foundry向けの比率が上昇。



売上収益 地域別

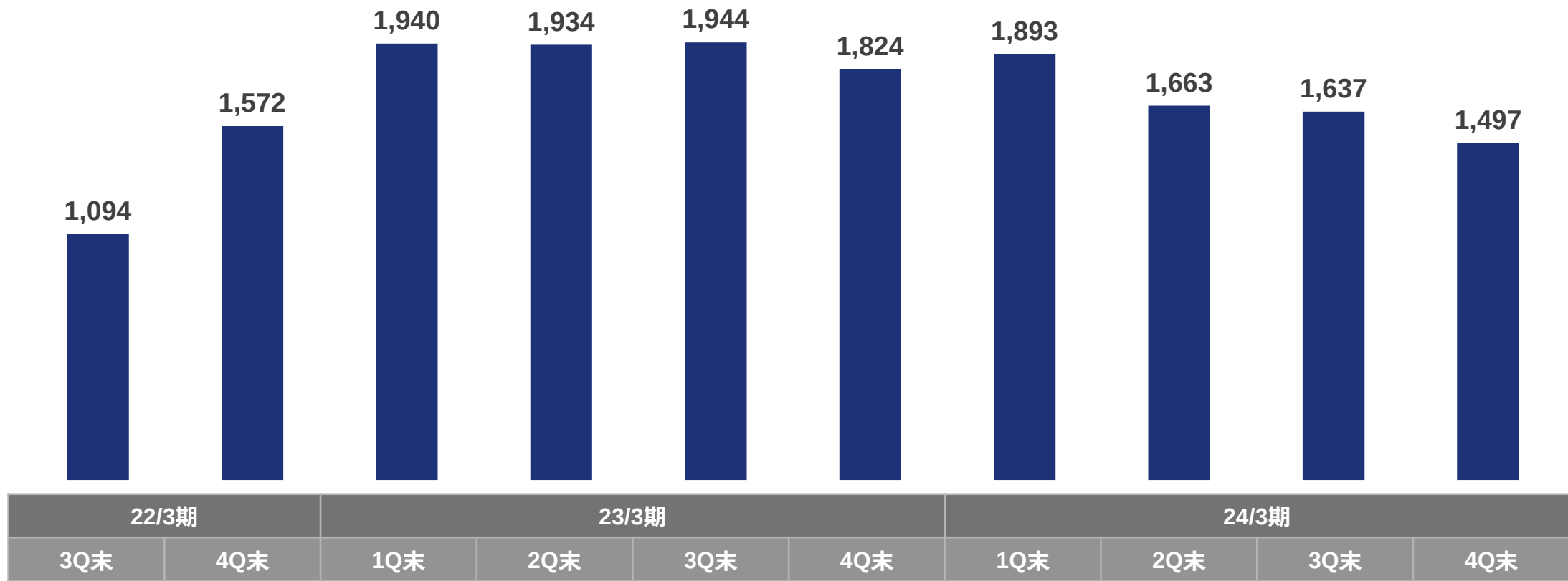
24/3期は、世界各国でのNAND市況悪化と中国での投資活発化の影響により、中国売上比率が拡大。
今後、世界各国での先端品向け投資回復に伴い、中国売上比率は従来水準へ。



受注残高の推移

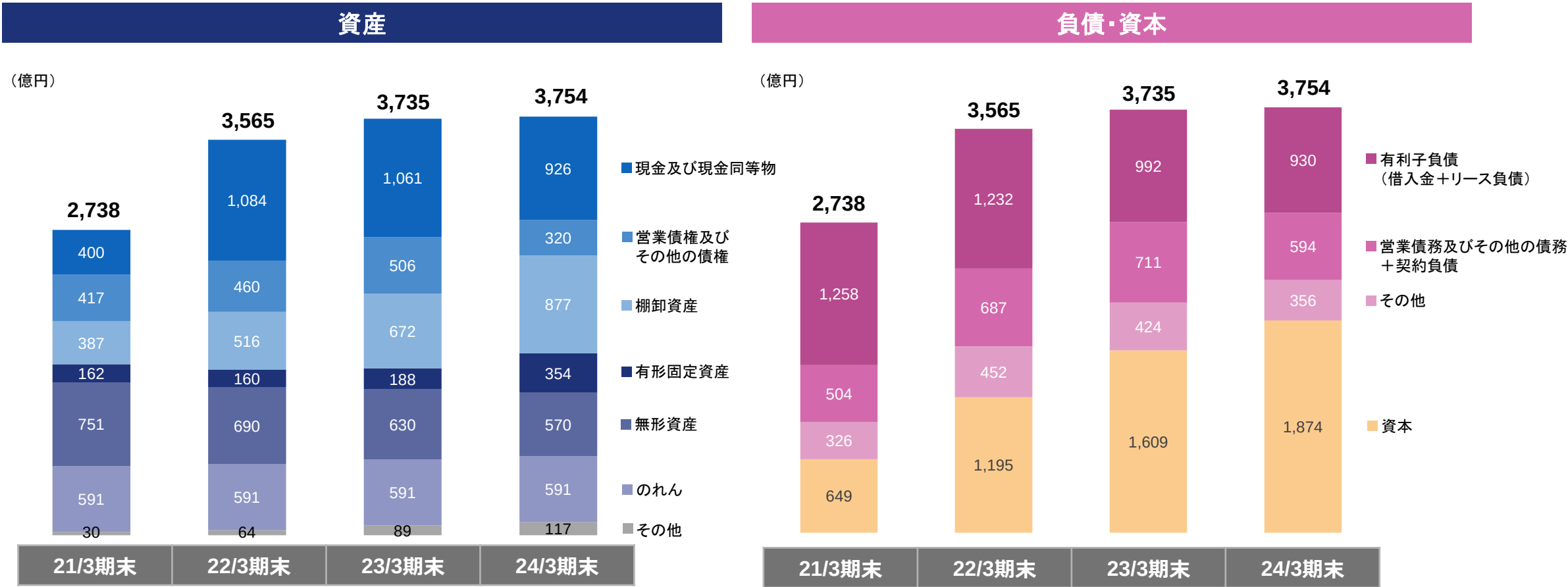
長納期案件の売上転換が進み、受注残高は平常化。
受注高は、2Qを底に3Qから回復しており、4Qも概ね計画通り。

(億円)



貸借対照表

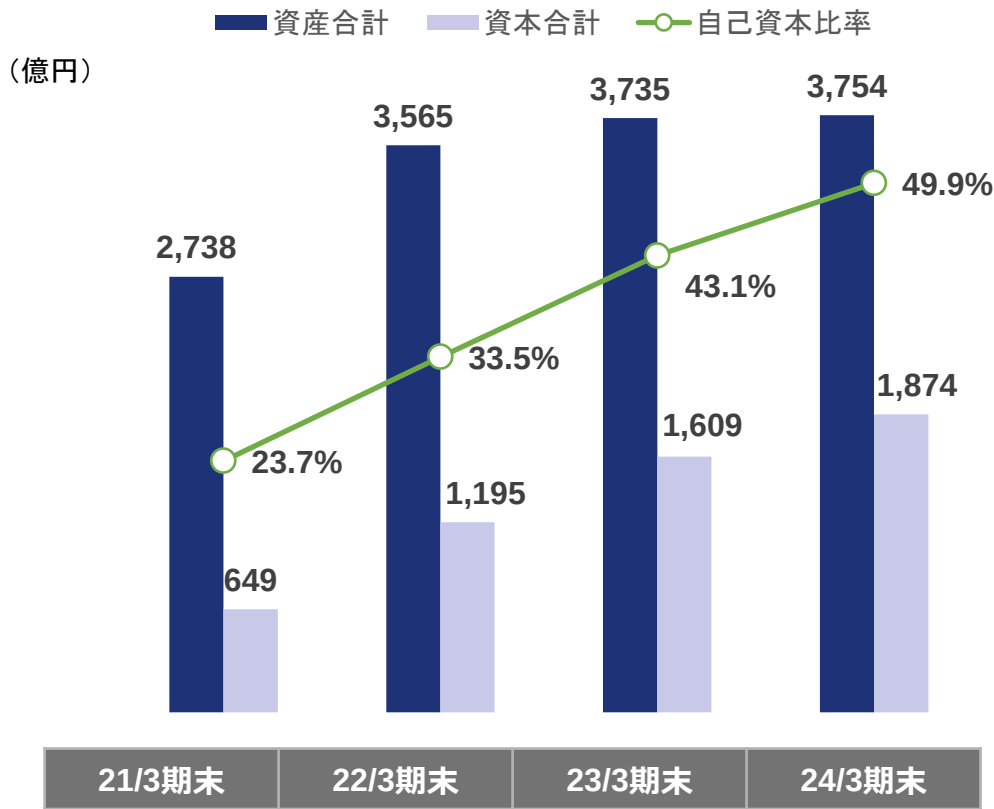
資産合計は、現金等、営業債権等は減少したものの、棚卸資産、有形固定資産が増加し、23/3期末比で19億円増加。負債合計は、営業債務等の減少、有利子負債の返済により、23/3期末比で246億円減少。資本合計は、利益剰余金の増加などにより、23/3期末比で265億円の増加。



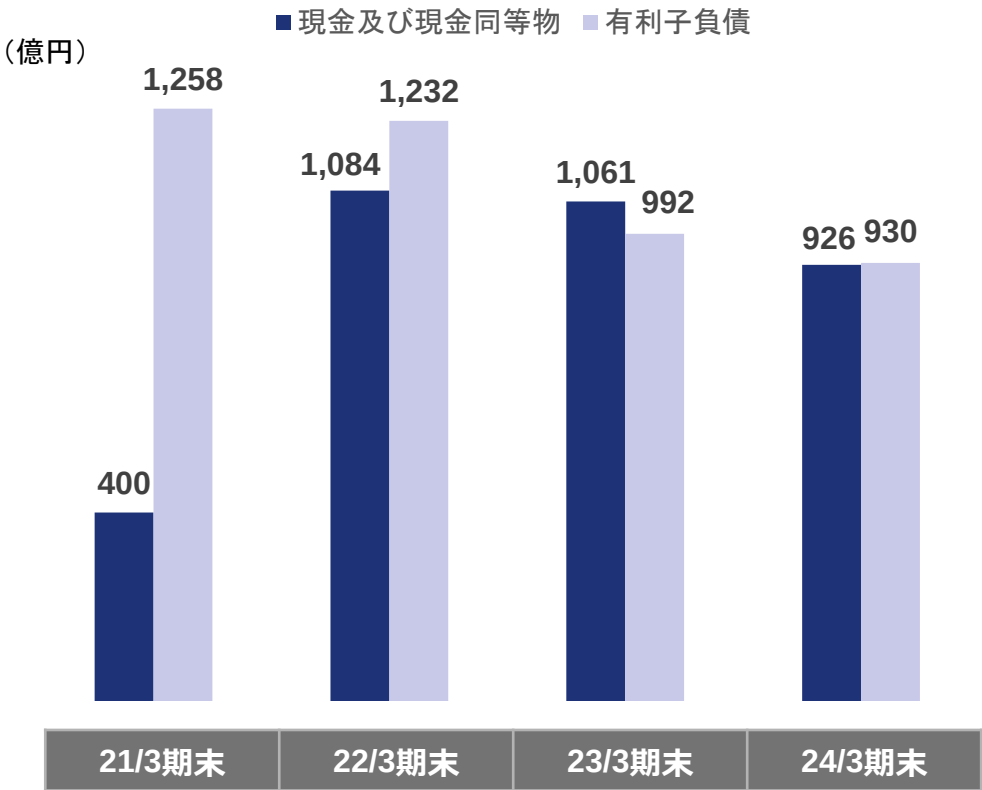
自己資本比率 & 現金及び現金同等物／有利子負債

自己資本比率は、24/3期末で50%。
24/3期末のネットデットは4億円。有利子負債は計画どおりに縮減。

資産合計／資本合計／自己資本比率

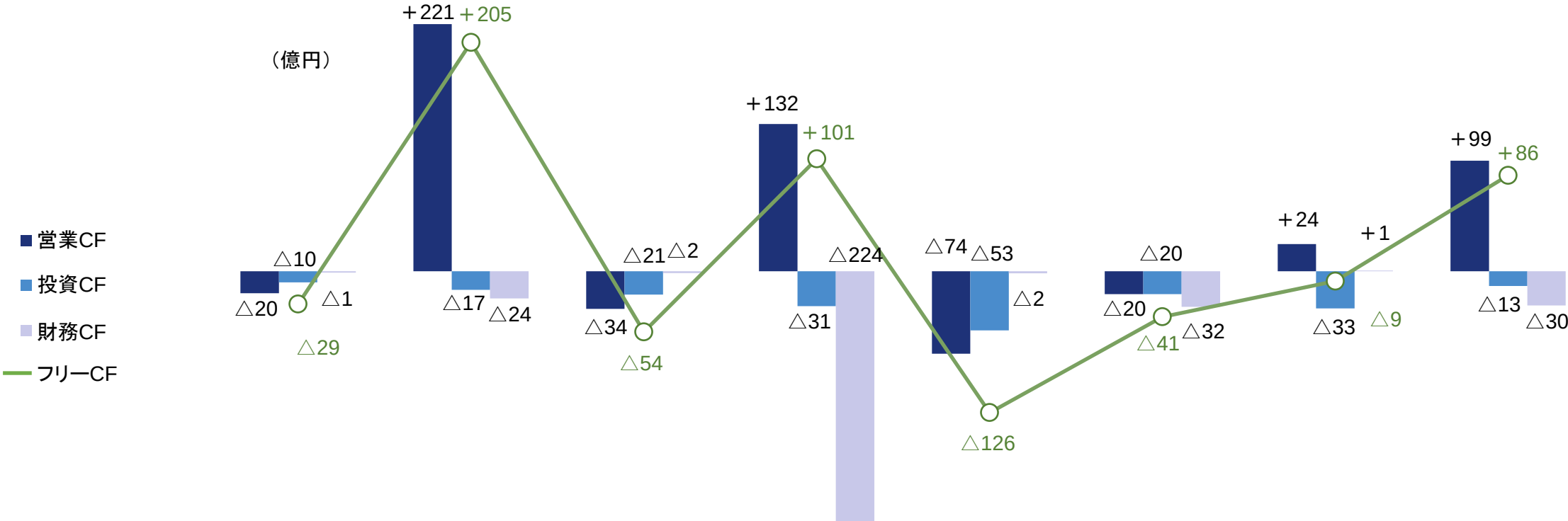


現金及び現金同等物／有利子負債



四半期別キャッシュ・フロー

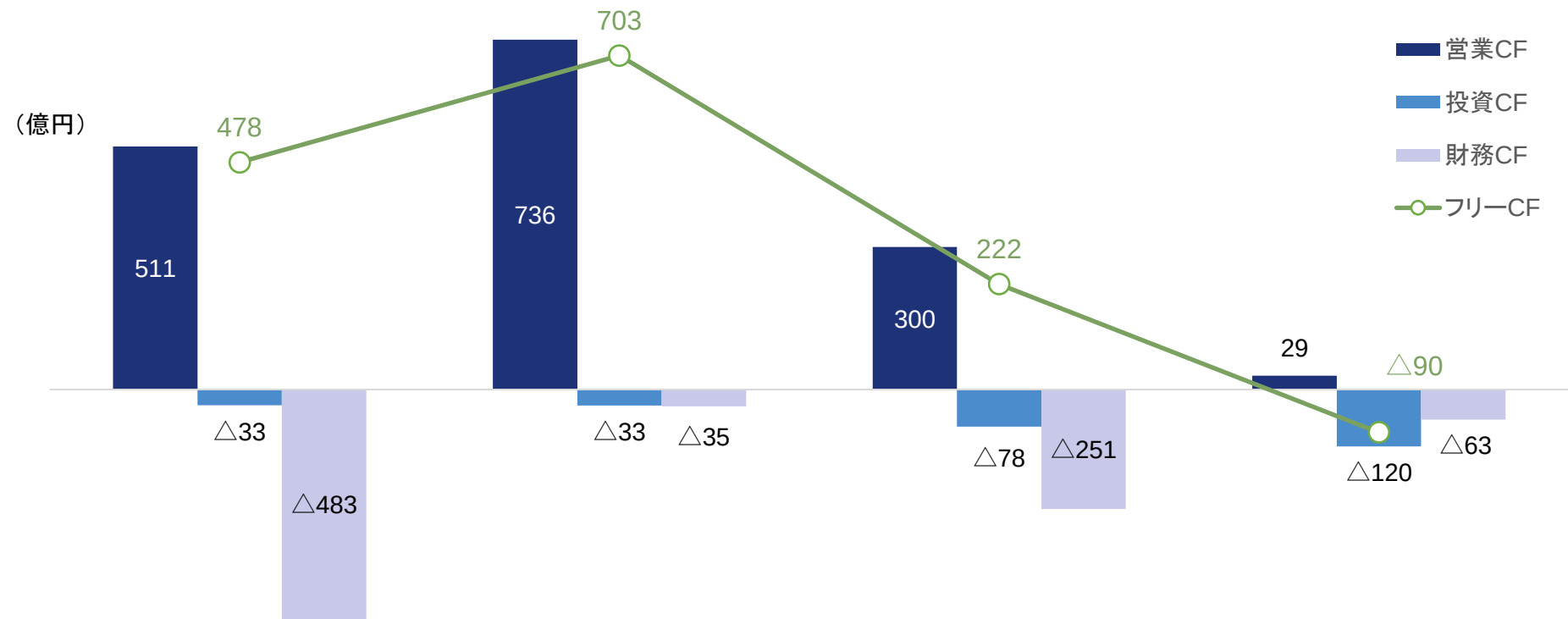
4Qは、売上収益の回復に伴って営業CFが回復。



(億円)	23/3期				24/3期			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
営業CF	△20	+221	△34	+132	△74	△20	+24	+99
投資CF	△10	△17	△21	△31	△53	△20	△33	△13
財務CF	△1	△24	△2	△224	△2	△32	+1	△30
フリーCF	△29	+205	△54	+101	△126	△41	△9	+86
現金及び現金同等物残高	1,065	1,242	1,184	1,061	945	876	865	926

キャッシュ・フロー

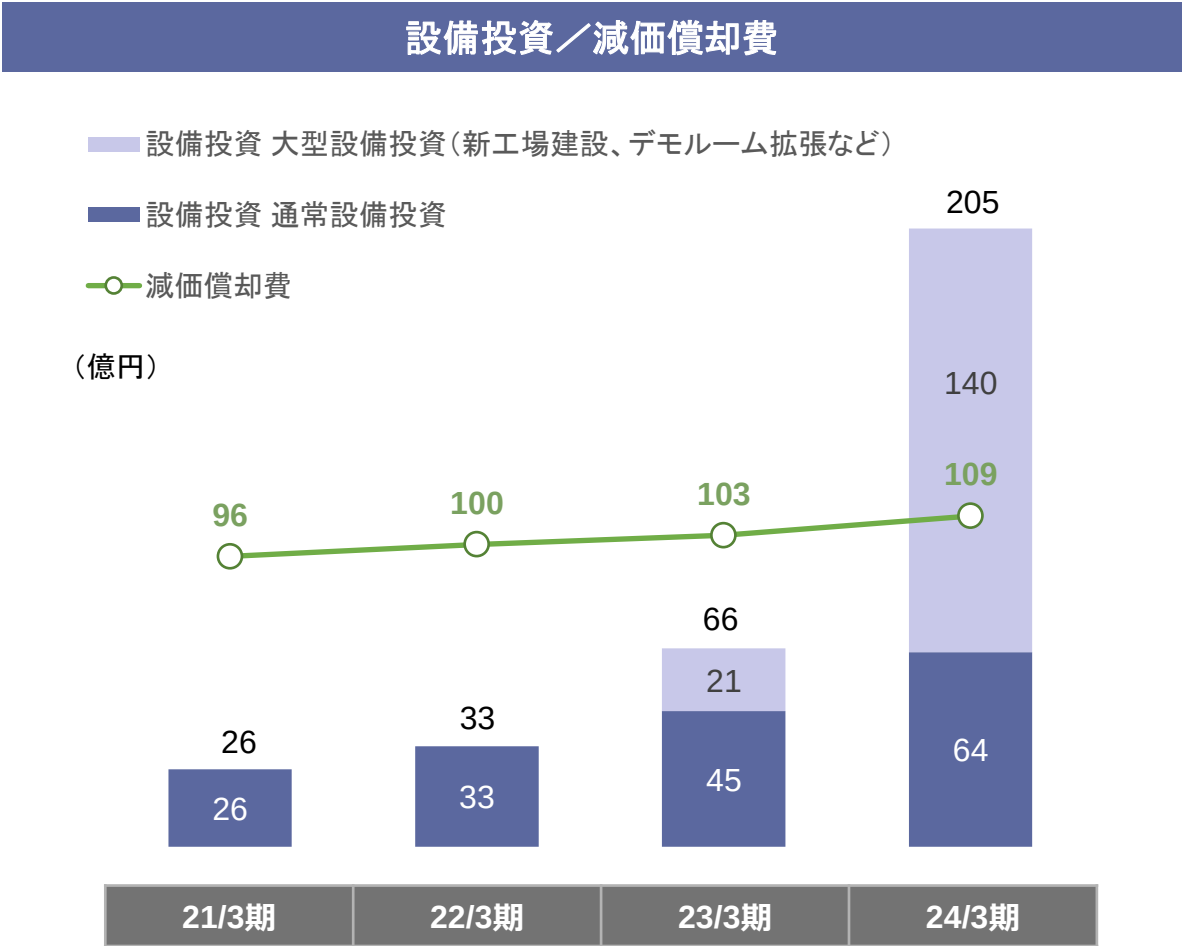
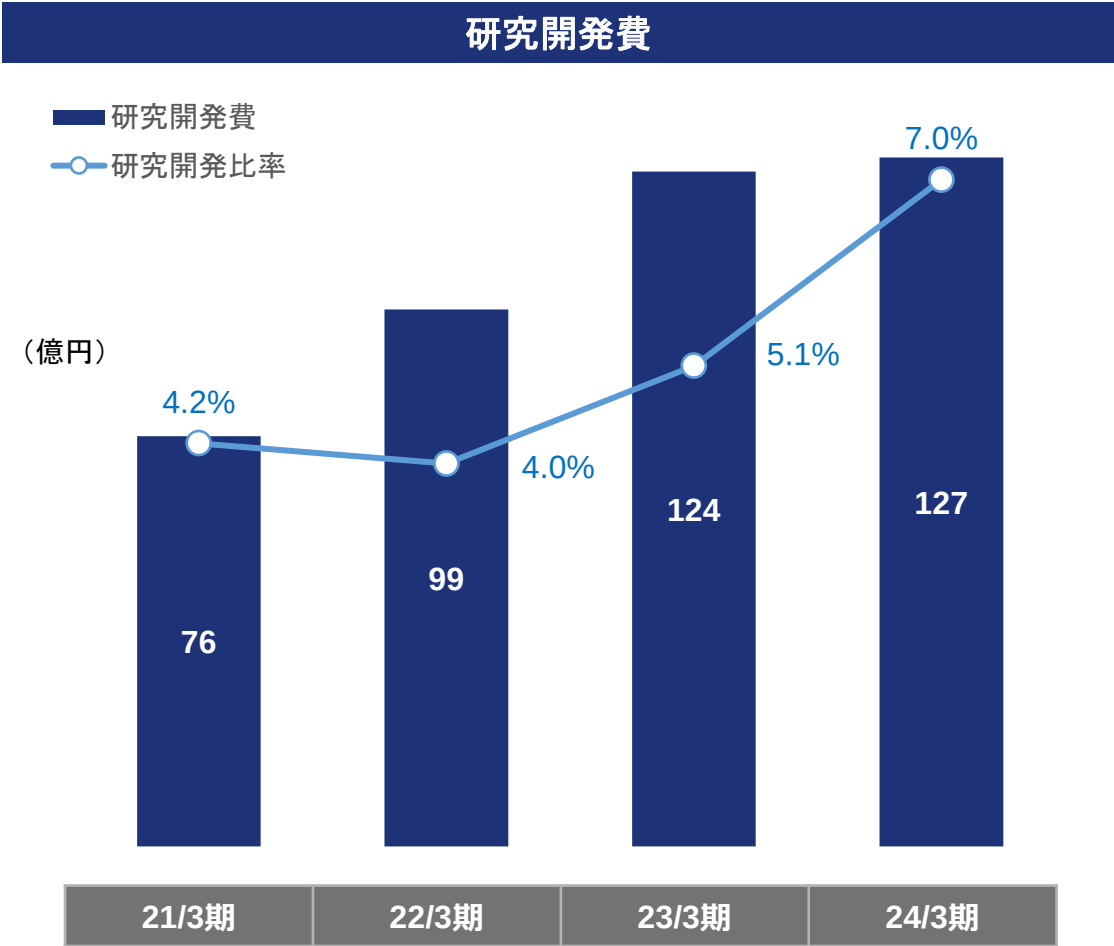
売上収益減少の影響で営業CFが減少し、フリーCFも減少。



(億円)	21/3期	22/3期	23/3期	24/3期
営業CF	511	736	300	29
投資CF	△33	△33	△78	△120
財務CF	△483	△35	△251	△63
フリーCF	478	703	222	△90
現金及び現金同等物残高	400	1,084	1,061	926

研究開発費／設備投資／減価償却費

中長期的な需要拡大を見据えて研究開発投資、設備投資を継続。
研究開発費は前期並み。設備投資は前期比3.1倍。減価償却費は前期比微増。





2025年3月期連結業績予想

2024年3月期連結決算概要

- NANDを中心に一部の半導体デバイスメーカーの投資抑制が続いたものの、市況は底を打ったと認識。中国では成熟ノード向けの設備投資が活発化、世界各国でも先端品開発への投資継続。
- 当社24/3期は前期比で減収減益ながら、1Qを底に業績回復傾向が顕著。中長期的な需要増加に対応するため、積極投資を継続。

2025年3月期連結業績予想

- 半導体関連市況の回復傾向は持続、25/3期後半に世界各国で先端品への設備投資が回復し始めると想定。
- 装置・サービスのそれぞれが回復し、24/3期比で増収増益を予想。

今後の取り組み

- 半導体関連市況は回復傾向が続き、中長期的に大きな成長を遂げるとの見方に変更なし。
- 3D NANDで先行した技術的優位性をDRAMやLogicに展開。パワーデバイス向けも柱の一つへの成長をめざす。

2025年3月期業績予想

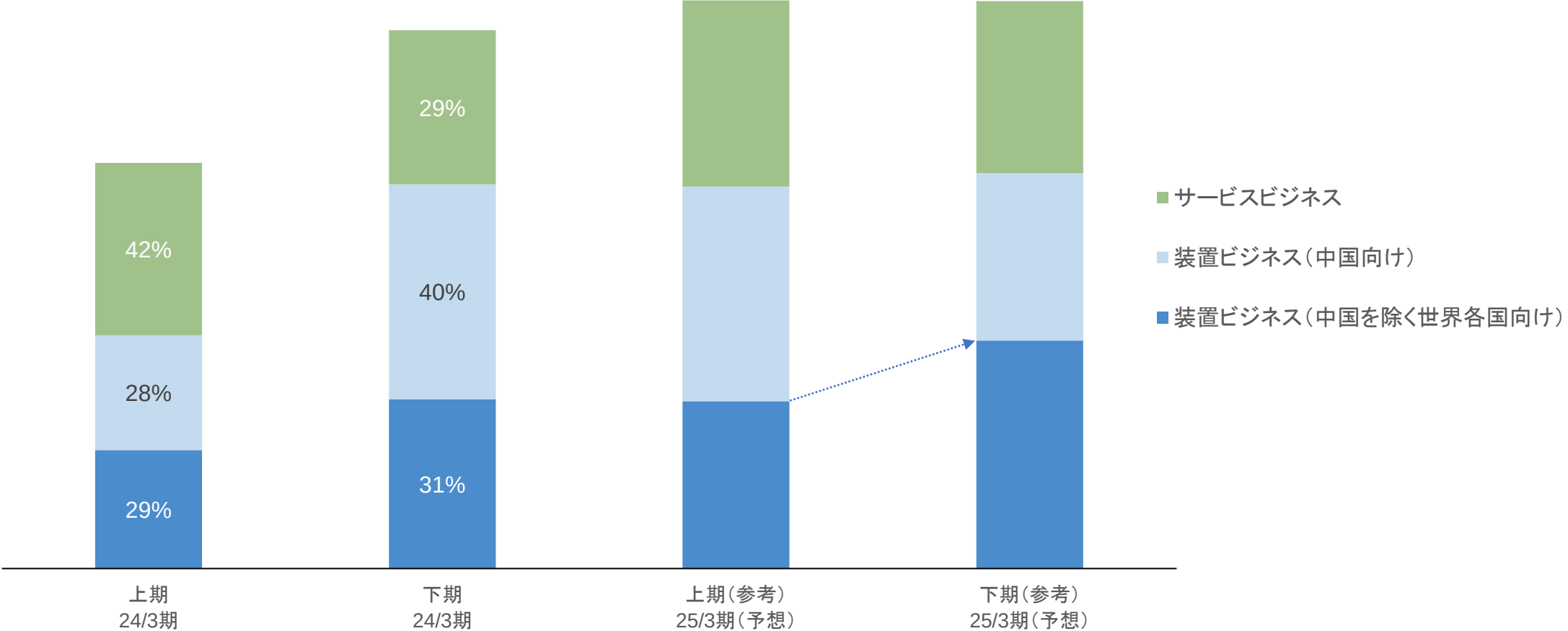
売上収益は24/3期比で20%増、売上総利益、調整後営業利益、調整後当期利益は24%増、35%増、30%増を見込む。配当金は半期当たり5円増の年間32円を想定。

(億円)	23/3期	24/3期	25/3期(予想)	前期比
売上収益	2,457	1,808	2,175	+20.3%
売上総利益	1,008	750	927	+23.7%
売上総利益率	41.0%	41.5%	42.6%	+1.1pts
調整後営業利益	643	378	510	+34.8%
調整後営業利益率	26.1%	20.9%	23.4%	+2.5pts
調整後当期(四半期)利益	460	273	356	+30.4%
調整後当期(四半期)利益率	18.7%	15.1%	16.4%	+1.3pts
営業利益	561	307	448	+45.7%
営業利益率	22.8%	17.0%	20.6%	+3.6pts
税引前当期(四半期)利益	559	298	440	+47.9%
税引前当期(四半期)利益率	22.7%	16.5%	20.2%	+3.7pts
当期(四半期)利益	403	224	290	+29.9%
当期(四半期)利益率	16.4%	12.4%	13.3%	+0.9pts
1株当たり配当金(円)	-	11*1	32	+5.0円/半期
配当性向	-	11.4%	25.7%	+14.3pts

*1 24/3期の1株当たり配当金につきましては、上場時期が下半期であることを踏まえて半期分の金額とし、全額期末配当による支払いを予定しております。

2025年3月期業績予想 上期・下期別

上期はサービスのレガシー装置が売上収益を押し上げる見込み。
下期はサービスのレガシー装置が落ち着き、中国向けを慎重に見る一方で、世界各国で先端品向け装置需要が回復し始めると想定して計画策定。

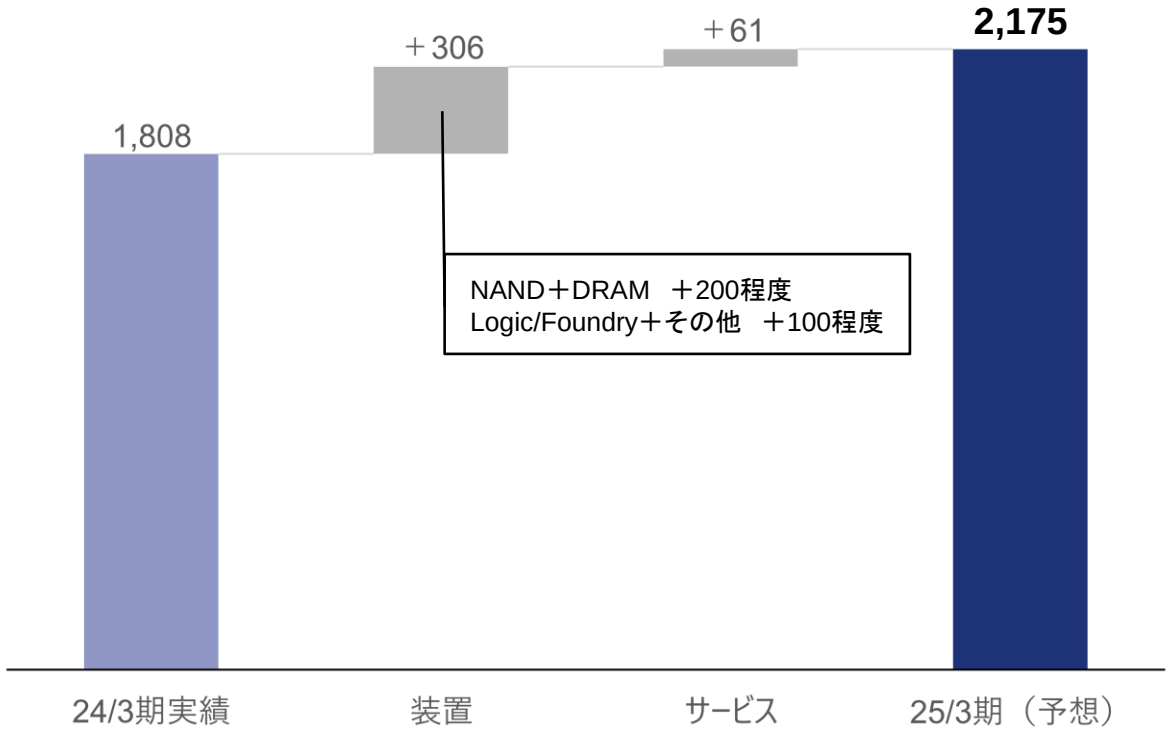


2025年3月期業績予想 増減要因

25/3期はDRAM、Logic/Foundry向けを中心とした売上回復と売上総利益率の上昇により、調整後営業利益の増加を見込む。

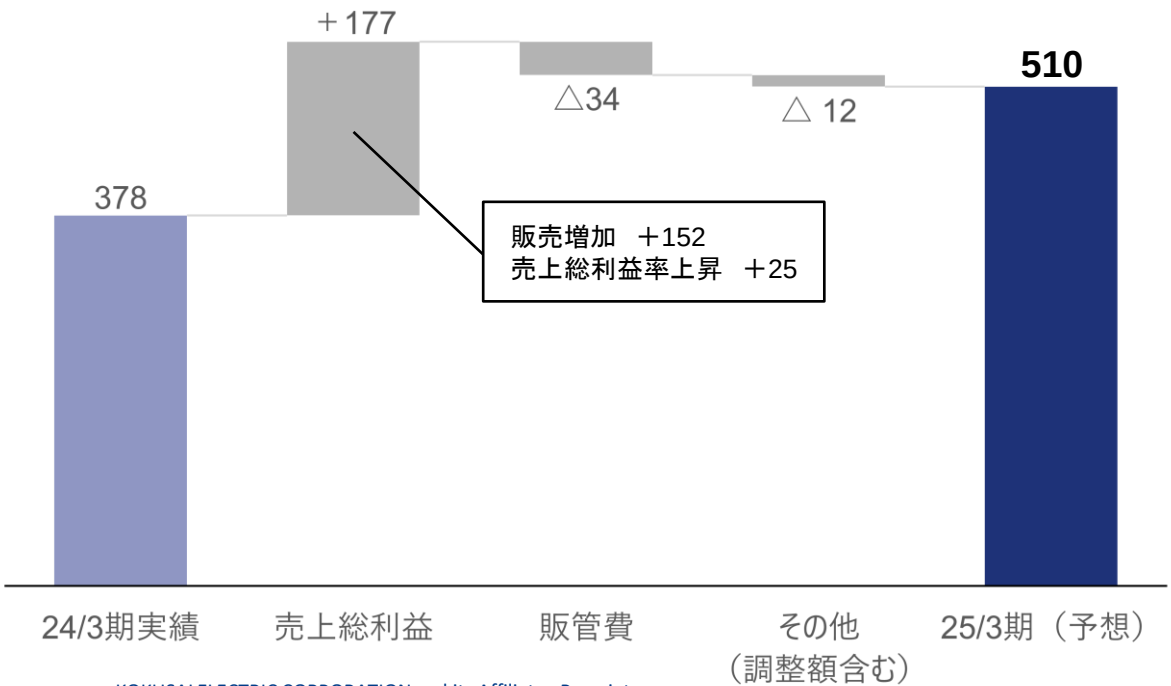
売上収益

(億円)



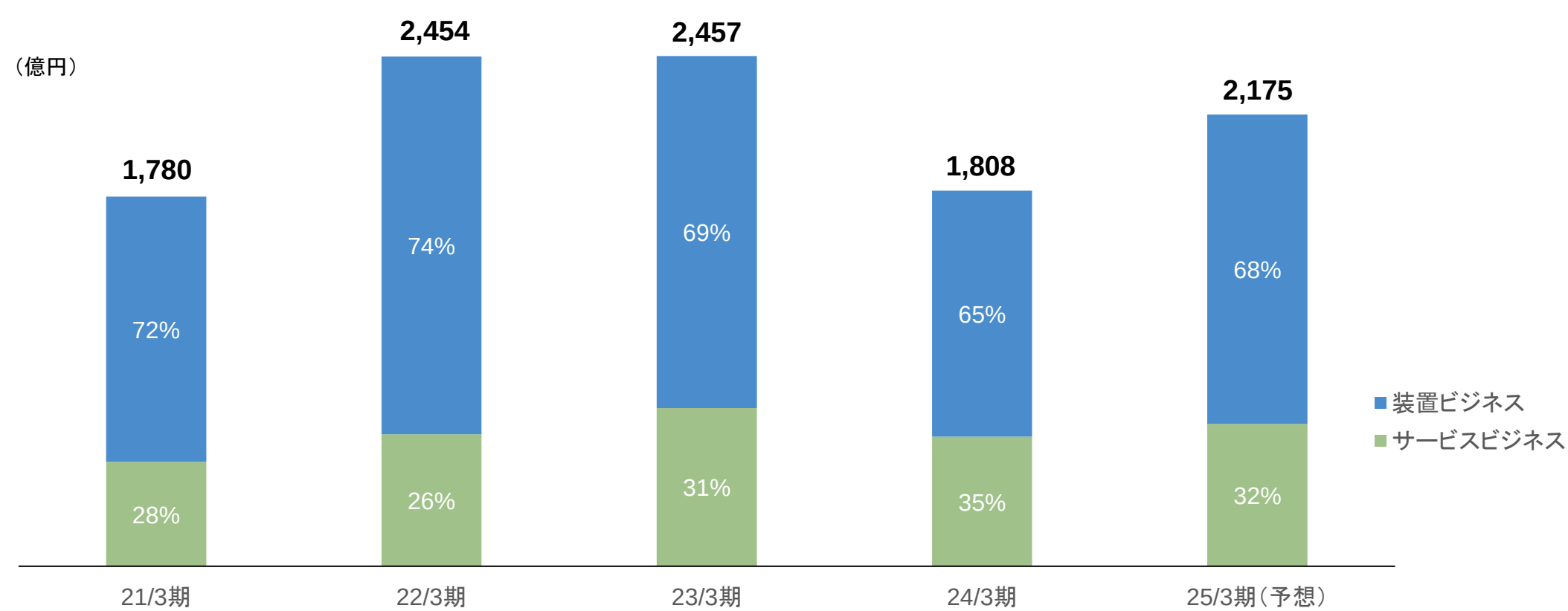
調整後営業利益

(億円)



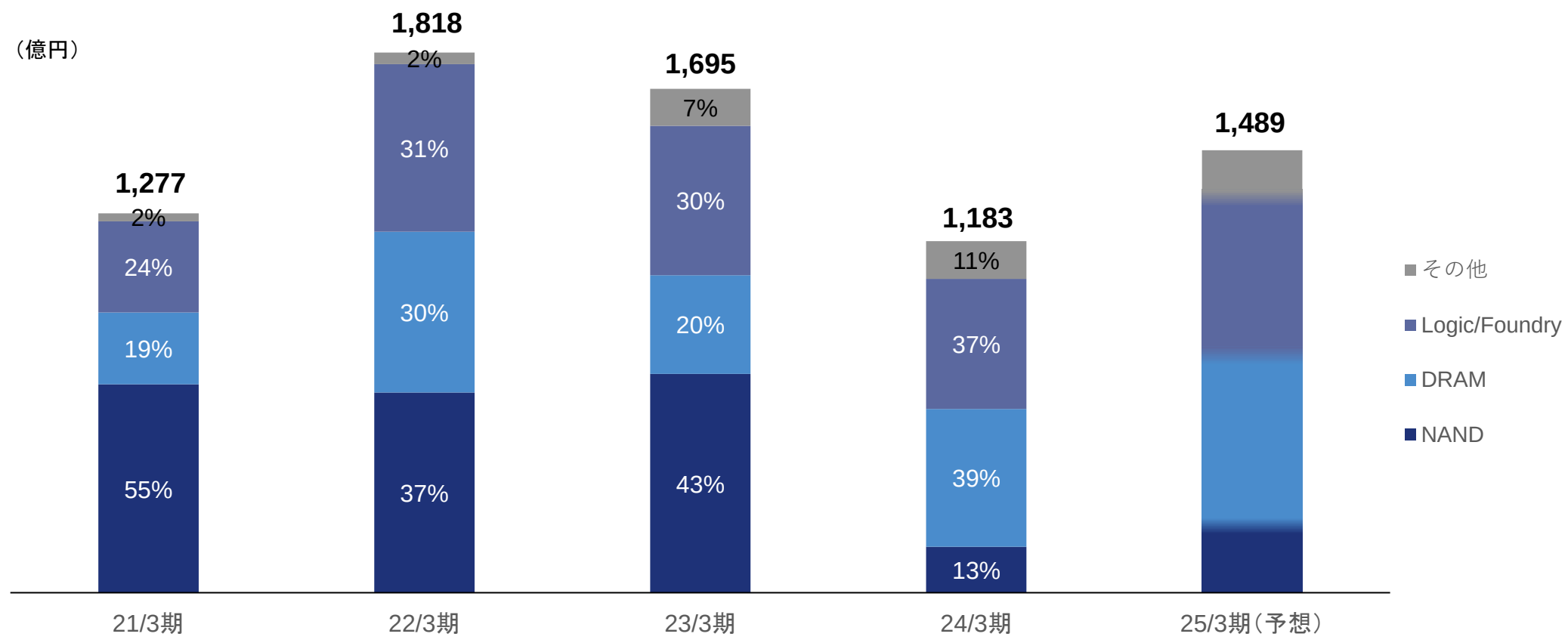
売上収益予想　ビジネス別

装置、サービスともに24/3期比で増収となり、平常時のビジネス別売上構成比が持続する見通し。
25/3期の装置売上は24/3期比で26%増、サービス売上は24/3期比で10%増を見込む。



売上収益予想(300mm装置のみ) アプリケーション別

25/3期は、各アプリケーションで売上が増加し、アプリケーション別売上構成比に大きな変化はない見通し。
中国での活発な設備投資はDRAM、Logic/Foundryに寄与、NANDは開発用途を中心に、25/3期の終盤に回復を見込む。





今後の取り組み

2024年3月期連結決算概要

- NANDを中心に一部の半導体デバイスメーカーの投資抑制が続いたものの、市況は底を打ったと認識。中国では成熟ノード向けの設備投資が活発化、世界各国でも先端品開発への投資継続。
- 当社24/3期は前期比で減収減益ながら、1Qを底に業績回復傾向が顕著。中長期的な需要増加に対応するため、積極投資を継続。

2025年3月期連結業績予想

- 半導体関連市況の回復傾向は持続、25/3期後半に世界各国で先端品への設備投資が回復し始めると想定。
- 装置・サービスのそれぞれが回復し、24/3期比で増収増益を予想。

今後の取り組み

- 半導体関連市況は回復傾向が続き、中長期的に大きな成長を遂げるとの見方に変更なし。
- 3D NANDで先行した技術的優位性をDRAMやLogicに展開。パワーデバイス向けも柱の一つへの成長をめざす。

事業環境の見通し

市況は24/3期に底を打ち、回復傾向が続くと想定。中長期的に大きな成長を遂げるとの見方に変更なし。

半導体デバイス市場

- 半導体デバイス市場はCY23に底を打っており、CY24後半から世界各国での先端品への投資が回復し始める。
- 中国での成熟ノード向けの活発な設備投資は、今後数年持続するものと見込まれる。
- 中長期的には、電子機器の需要拡大、データセンターの拡充、環境負荷低減への投資(GX)等により、大きな成長が期待される。

当社の事業環境

- 半導体デバイス市場の回復に伴い、当社では25/3期後半から世界市場で先端品向け装置の需要が回復し始めると想定。
- 中国での成熟ノード向け装置の需要は今後数年続くものの、当社では25/3期半ば以降に慎重な見方。
- WFE^{*1}市場のCY24の規模はCY23並みか微増ながら、今後数年でUSD110～120Bn程度まで成長すると想定。

半導体デバイス／半導体製造装置の世界市場規模(単位:USD Bn)

	2010年	2022年	2023年	2027年(予想)
半導体デバイスの世界市場規模	296.7	613.9	559.1	813.4
半導体製造装置の世界市場規模	30.4	97.7	99.0	132.6

出所: TechInsights Inc. Semiconductor Forecast (March 2024)
出所: TechInsights Inc. IC MANUFACTURING EQUIPMENT MARKET HISTORY AND FORECAST (2018 – 2028) (March 2024)

^{*1} WFE: Wafer Fab Equipmentの略で、半導体製造装置を指します。

装置ビジネス戦略

半導体デバイスの多層化・三次元化に対して、技術優勢性の高いバッチALD対応成膜装置とトリートメント装置の研究開発、新規POR^{*1}獲得、販売拡大に注力し、WFE市場成長を上回る売上成長をめざす。

バッチ 成膜装置	世界シェア No.1 (2022年) ^{*2}	
	バッチALD対応 成膜装置	■数十枚以上のウェーハを一括処理するバッチ成膜装置のうちALD技術に対応する装置で、高難易度成膜と高生産性の両立が可能。 ■デバイスの複雑化に伴ってニーズが拡大。 ■ALD:Atomic Layer Depositionの略。当社グループでは、複数のガスをサイクリックに供給する工程を伴い、原子層レベルで成膜する手法を「ALD」と呼ぶ。
	バッチCVD対応 成膜装置 バッチ酸化対応 成膜装置	■数十枚以上のウェーハを一括処理するバッチ成膜装置のうちCVD技術や酸化技術に対応する装置。高生産性が特徴。 ■CVD:Chemical Vapor Depositionの略。ガスを同時に供給し、気相で化学反応を起こして成膜する手法。当社グループではLP-CVD:Low Pressure CVDに集中。
トリートメント (膜質改善) 装置	世界シェア No.2 (2022年) ^{*3}	
	枚葉トリートメント装置	■成膜後にプラズマや加熱により膜質を改善させることを目的とした装置で、独自のプラズマ技術により優れた等方性とステップカバレッジを実現可能。 ■デバイスの複雑化に伴ってニーズが拡大。 ■低温環境における膜質改善のニーズが拡大。



ミニバッチ成膜装置
「TSURUGI-C²® 劔®」

ラージバッチ成膜装置
「AdvancedAce®-300」

ラージバッチ成膜装置
「VERTEX® Revolution」

枚葉トリートメント装置
「MARORA®」

枚葉トリートメント装置
「TANDUO®」

^{*1} POR:Process of Recordの略で、顧客の半導体製造プロセスにおける製造装置認定を指します。

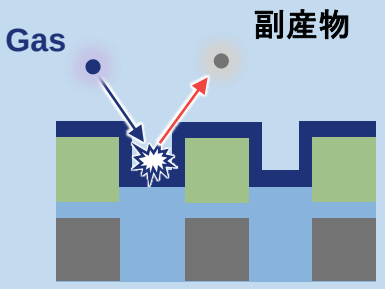
^{*2} 出典:TechInsights Manufacturing Analysis Inc.(VLSI)“TI_ALD Tools_YEARLY” 2023(April)

^{*3} Gartnerによる半導体製造装置(前工程)セグメントにおける「RTP and Oxidation/Diffusion」を「トリートメント装置」と定義(出典:“Gartner®, Market Share: Semiconductor Wafer Fab Equipment, Worldwide, 2022, Bob Johnson, Gaurav Gupta, Menglin Cao, 17 April, 2023”)

バッチ成膜装置：デバイス複雑化に伴いバッチALD需要が拡大

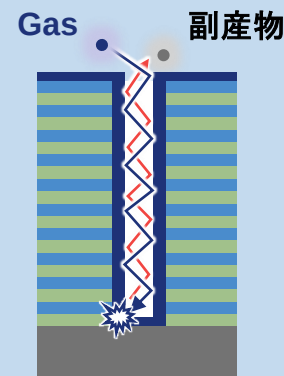
デバイス構造の複雑化に伴い、**難易度の高い成膜**が不可欠になり、**生産性の課題**も顕在化。
バッチALDは、**高難易度成膜と高生産性**を両立したソリューションとしてシェアを獲得。

2D NANDにおける成膜



- 広いスペースでガスの反応が起こるため、ガスの移動距離が短い。
- 成膜が必要な表面積が小さく、またアスペクト比が低い構造。

3D NANDにおける成膜

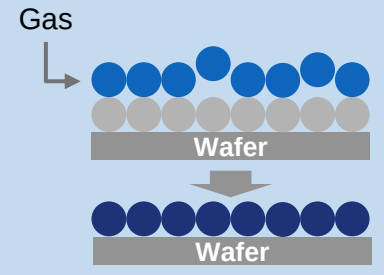


- 成膜が必要な表面積が拡大し、ガスの移動距離が長くなるため、成膜にかかる時間が増加。
- 表面積の拡大とアスペクト比の上昇が同時に発生し、難易度の高い成膜が不可欠。

難易度の高い高品質成膜と高い生産性の両立が可能な
バッチALDの需要が拡大

ALD技術
高難易度・高品質

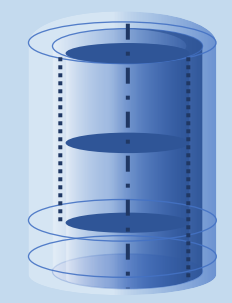
ウェーハ表面で
ガスが反応



※イメージ

バッチ成膜技術
高生産性

数十枚以上のウェーハを
一度に成膜



KOKUSAI ELECTRIC

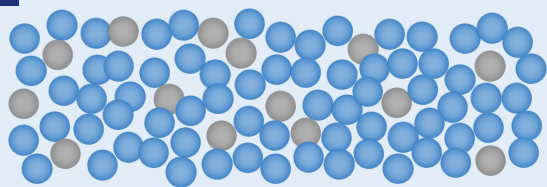
KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION and its Affiliates Proprietary
Copyright © KOKUSAI ELECTRIC Corporation 2024. All rights reserved.

30

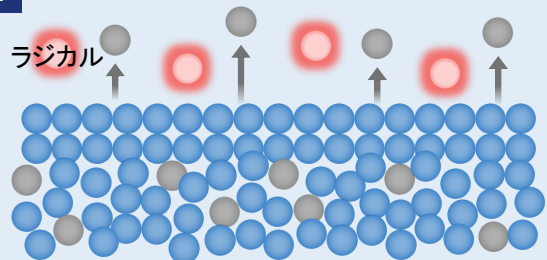
トリートメント装置：デバイス複雑化に伴いトリートメント需要も拡大

プラズマや加熱による幅広い温度レンジでのトリートメント(膜質改善)が可能。
高い生産性で優れた等方性、ステップカバレッジを実現するソリューション。

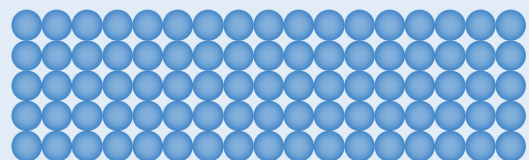
1 低温成膜による不純物の発生



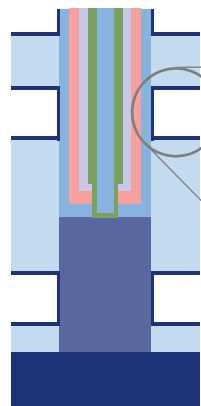
2 潤沢なラジカルで不純物を除去



3 トリートメント(膜質改善)後



NAND・DRAMにおけるトリートメント(膜質改善)



優れた等方性と
ステップカバレッジ

- 成膜後に独自のプラズマ方式が生み出す潤沢なラジカルにより、コンフォーマルに膜質を改善。
- 複雑なデバイス構造に対して、高生産性と高品質でのトリートメント(膜質改善)を実現。
- NANDからDRAMへ適用範囲が拡大中。

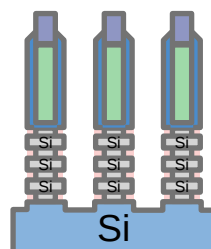
Logicにおけるトリートメント(膜質改善)

前処理(下地処理)



枚葉トリートメント装置
MARORA®

選択成膜



後処理(膜質改善)



枚葉トリートメント装置
MARORA®

- MARORA®と選択成膜を組み合わせることによりエッチングの工程を短縮し、膜へのダメージを回避。
- MARORA®による前処理(下地処理)と後処理(膜質改善)によって、理想的な選択成膜を実現。

アプリケーション別の取り組み

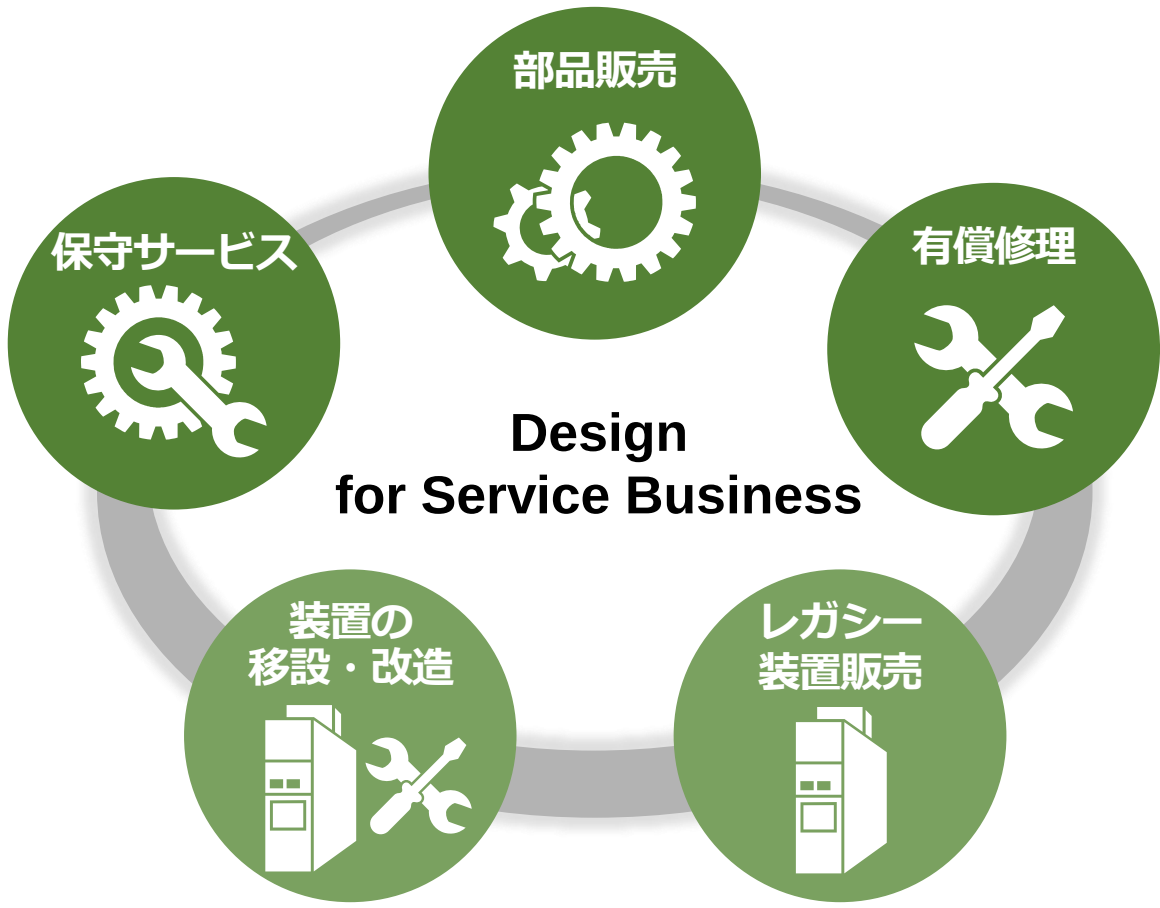
3D NANDで先行した技術的優位性をDRAMやLogicに展開し、NAND、DRAM、Logic/Foundry向けのそれぞれでバランスのとれた成長をめざす。パワーデバイス向けも柱の一つへの成長をめざす。

	事業環境	当社の取り組み
DRAM	・中国向け装置需要が25/3期半ばまで当社業績をけん引。 ・25/3期後半から世界で先端品向け装置の需要が本格回復。 ・生成AIの普及によるHBM^{*1}需要拡大により、先端品向け装置の需要も高まると期待。	・先端DRAMの高難度成膜で新規PORを獲得。 ・デバイス進化でTAM^{*2}拡大、さらなる新規POR獲得をめざす。 ・3D DRAMでのデバイス構造複雑化に伴い、3D NANDと同様にシェア拡大をめざす。
Logic/Foundry	・中国成熟ノード向け装置の需要が25/3期半ばまで業績を下支え。 ・25/3期後半にはDRAM向けに続いて先端品向け装置の需要が本格回復。	・GAA^{*3}で新規開発PORを獲得。 ・GAA第2世代でTAMが拡大、さらなる新規POR獲得をめざす。 ・CFET^{*4}でのバッチ成膜プロセス増加(FinFET^{*5}比1.4倍)に伴いシェア拡大をめざす。
NAND	・足元では開発用途装置の需要が持続。 ・25/3期終盤から世界で先端品向け装置の需要が回復し始め、26/3期での本格回復。	・ラージバッチ成膜装置＋ミニバッチ成膜装置により、3D NANDの成膜プロセスで圧倒的シェアを獲得済み。 ・市況回復とデバイスの多層化が進むにつれて需要拡大が期待。
SiCパワーデバイス (サービスビジネス)	・高温活性化アニール装置へのニーズ拡大。 ・デバイスのウェーハサイズが150mmから200mmに移行するとともに需要拡大が期待。	・25/3期は高温活性化アニール新製品投入を進めつつ、既存製品での売上伸長を見込む。 ・26/3期より高温活性化アニール新製品での売上拡大を見込む。

^{*1} HBM: High Bandwidth Memory (高帯域幅メモリー)の略 ^{*2} TAM: Total Addressable Marketの略 ^{*3} GAA: Gate All Aroundの略 ^{*4} CFET: Complimentary Field Effect Transistorの略 ^{*5} FinFET: Fin Field-Effect Transistorの略。

サービスビジネス戦略

市場の変動を受けにくく、安定した需要の見込めるビジネスとして、稼働台数の増加に合わせて、お客様のニーズに合わせたアフターサービスを提供。レガシー装置販売にも注力し、事業拡大をめざす。



- 当社が製造・販売する半導体製造装置のライフサイクル全般にわたって、部品販売、保守サービス、有償修理、装置の移設・改造のアフターサービスを提供。
- 部品販売・保守サービスでは、17/3期から23/3期にかけてインストールベースで前期比10%以上の成長を達成。
- “Design for Service Business”のコンセプトにより、部品販売・保守メンテナンス単価も上昇。
- グループ会社の販売ネットワークを活用してウェーハサイズ200mm以下のレガシー装置（新品・中古）販売にも注力。

Design for Service Businessの効果の一例

	従来製品	TSURUGIシリーズ
部品販売・保守メンテナンスの1台当たり売上	1x	4x～
装置売上のCAGR (17/3期～23/3期)	約20%	約75%

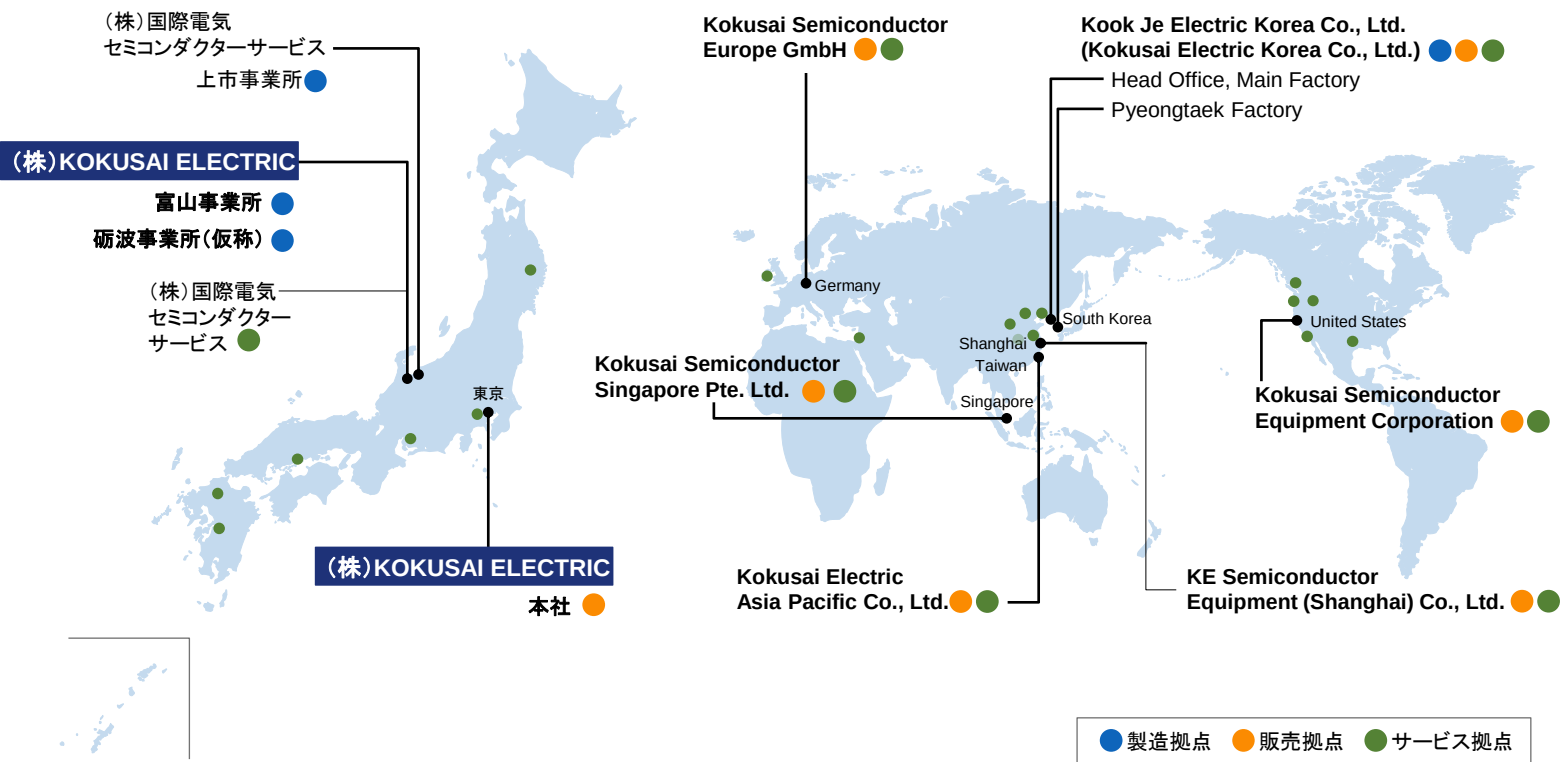
生産・開発・販売・サービス体制の拡充

24年秋の砺波事業所の操業開始に伴い、製造・開発キャパシティは大きく拡大へ。
シンガポール現地法人設立でアフターサービス・アジア販売を強化。

事業拠点

国内拠点

海外拠点

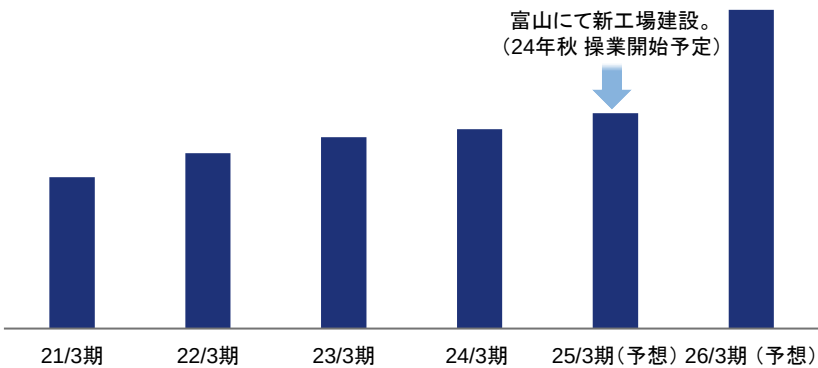


*1 グラフは最大生産台数/月 *2 グラフは評価装置台数 *3 21/3期との比較

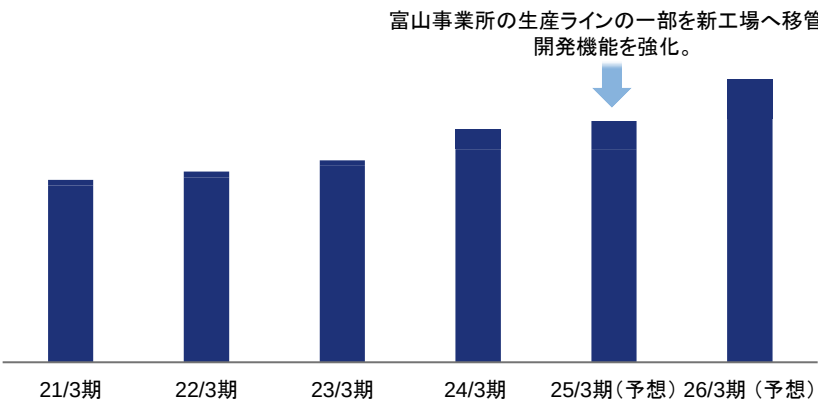
KOKUSAI ELECTRIC

製造・開発キャパシティ^{*1,2}

製造キャパシティ^{*1}は約2倍^{*3}に拡大の見通し



開発キャパシティ^{*2}は約1.5倍^{*3}に拡大の見通し



ESGの取り組み マテリアリティ

企業理念のもと、グループ全体でサステナビリティ経営レベルを高度化していくフェーズに移行しており、より一層、企業の社会的責任を自覚しながら事業とESGの両側面での取り組みを強化。

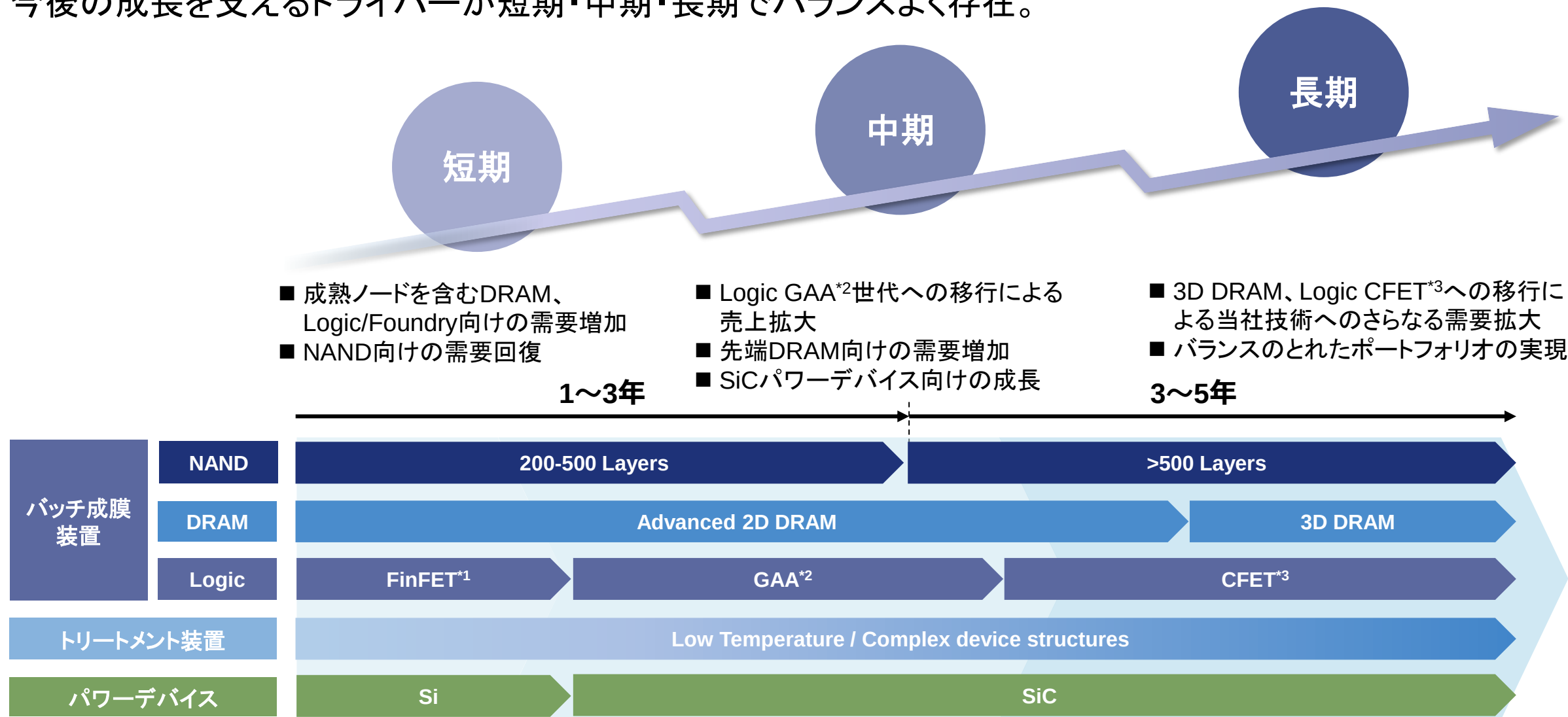
マテリアリティ／重点テーマ	マテリアリティに基づく活動アイテム
■ 創造と革新による社会への貢献	
新技術・新製品の創出	先行要素開発・外部機関との共同開発推進
お客様満足度の向上	VOC ^{*1} に対応した製品・技術、サービスの提供
経済パフォーマンスの向上	業績・投資等の向上、投資効果の確認
■ 持続可能な社会の創造・地球環境の保全	
環境負荷の低減	温室効果ガスの排出削減
	エネルギー管理の徹底
	廃棄物・有害物質管理の徹底
	水・排水管理の徹底
技術・製品を通じた環境への貢献	環境配慮製品の開発
持続可能な調達の推進	サプライチェーン・マネジメントの強化

マテリアリティ／重点テーマ	マテリアリティに基づく活動アイテム
■ イノベーション創出の源泉となる人財マネジメント	
多様な人財の尊重	ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョンの推進
自ら学び、考え、実行する人財の開発	グローバル人財の育成、優秀人財の確保
健康と安全の維持・向上	労働安全衛生マネジメントの強化
■ サステナビリティ経営の実現に向けたガバナンス体制の強化	
ガバナンスの強化	コーポレート・ガバナンスの強化
	コンプライアンスの徹底
重大ビジネスリスク・マネジメントの徹底	SCR ^{*2} ／CRリスク対策・BCPの強化
	情報セキュリティリスク対策・BCPの強化
経営の透明性確保	適時・適切な社内外への情報開示
■ 人権の尊重・配慮	
人権の尊重	人権に関する社内理解の促進・啓発

^{*1} Voice of Customerの略 ^{*2} Super Clean Roomの略

まとめ

今後の成長を支えるドライバーが短期・中期・長期でバランスよく存在。



*1 Fin Field-Effect Transistorの略 *2 Gate All Aroundの略 *3 Complimentary Field Effect Transistorの略 *4 HBM:High Bandwidth Memory(高帯域幅メモリー)の略

IR Day(機関投資家・証券アナリスト向け)のご案内

日時 : 6月18日(火)午前
形式 : ハイブリッド開催を予定
場所 : ベルサール八重洲
〒103-0028
東京都中央区八重洲1-3-7八重洲ファーストフィナンシャルビル
お問い合わせ : 株式会社KOKUSAI ELECTRIC
経営戦略本部 広報・IR部
prir.ke@kokusai-electric.com



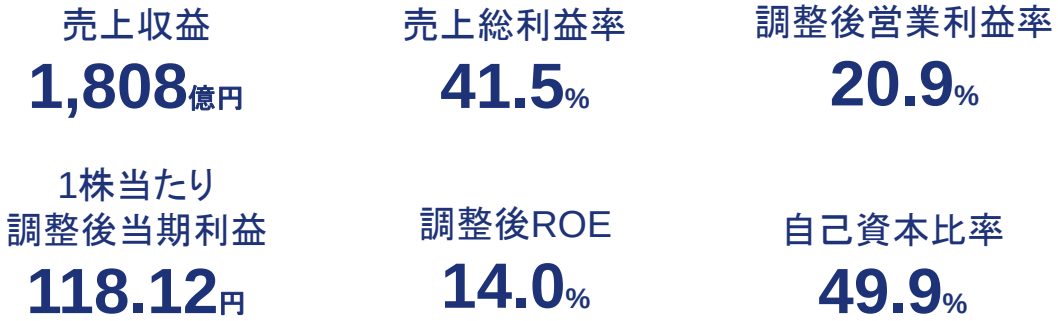
Appendix

KOKUSAI ELECTRIC at a Glance

沿革



財務概要(24/3期)

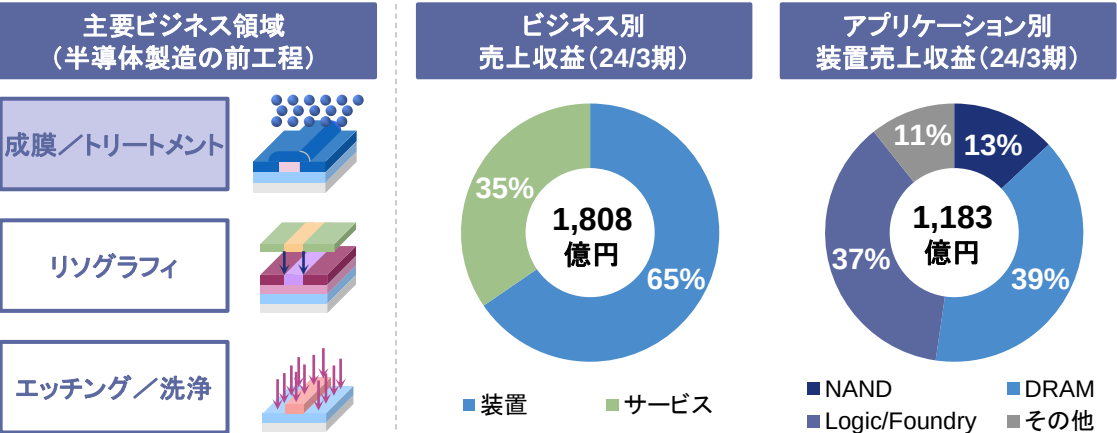


会社概要

会社名	株式会社KOKUSAI ELECTRIC	業種分類	電気機器
銘柄コード	6525	決算期	3月
代表取締役	金井 史幸	会計基準	国際会計基準(IFRS)
従業員数*1	2,472人(連結)、1,125人(個別)	単元株式数	100株
直近の 受賞状況	Intel EPIC Distinguished Supplier Award 2024 2024三星電子相生協力DAY 優秀協力会社 最優秀賞 TechInsights 10 BEST Suppliers 2023		

事業概要

当社は半導体製造の前工程における「成膜」プロセスに特化した装置専門メーカー



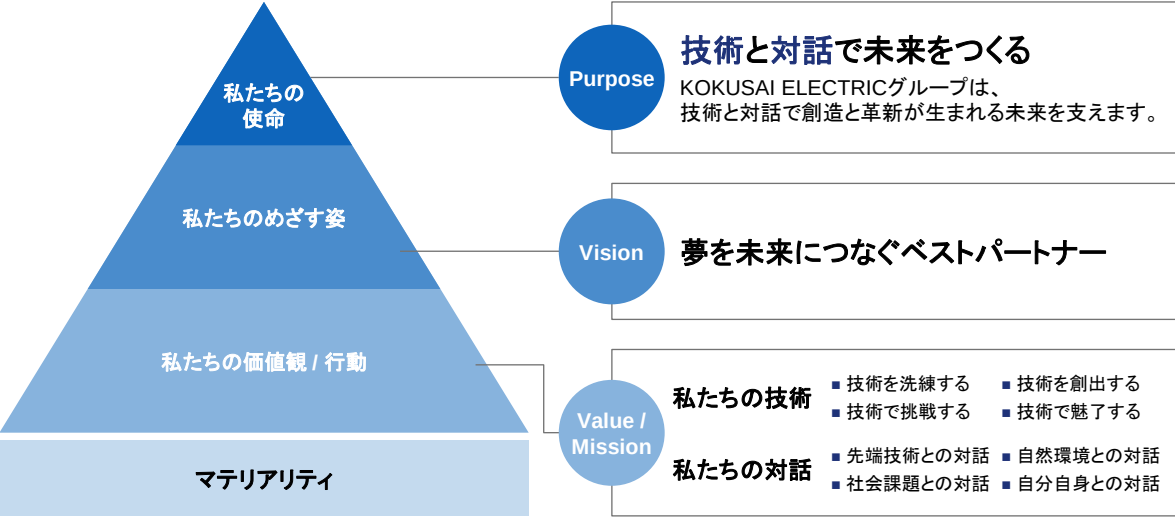
*1 2024年3月31日時点

経営方針

“KOKUSAI ELECTRIC Way”（企業理念）に基づき、事業活動とESGの取り組みの両側面から経済価値と環境・社会価値を追求し、SDGsの達成に寄与するとともに、創造と革新が生まれる未来を支え続ける。

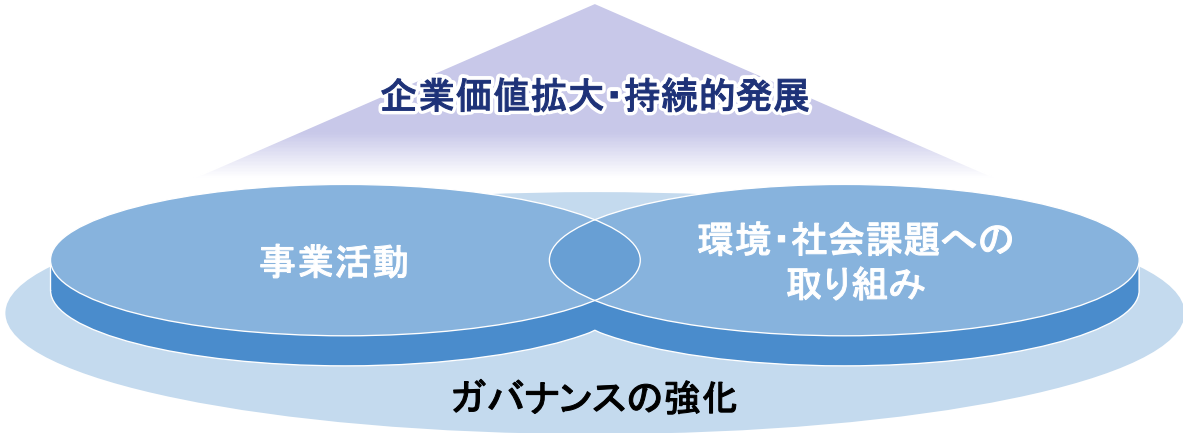
“KOKUSAI ELECTRIC Way”

KOKUSAI ELECTRIC Way



サステナビリティ経営

持続可能な社会の実現・SDGs達成への寄与



損益計算書及び研究開発費、設備投資、減価償却費

(百万円)	23/3期					24/3期				
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期
売上収益	56,035	64,385	65,216	60,085	245,721	32,710	44,995	53,956	49,177	180,838
売上総利益	23,090	27,489	26,359	23,867	100,805	14,275	19,890	21,741	19,059	74,965
売上総利益率	41.2%	42.7%	40.4%	39.7%	41.0%	43.6%	44.2%	40.3%	38.8%	41.5%
調整後営業利益	14,700	18,102	17,154	14,295	64,251	5,614	11,035	12,400	8,790	37,839
調整後営業利益率	26.2%	28.1%	26.3%	23.8%	26.4%	17.2%	24.5%	23.0%	17.9%	20.9%
調整後当期(四半期)利益	10,796	12,473	12,193	10,523	45,985	3,782	7,304	9,101	7,109	27,296
調整後当期(四半期)利益率	19.3%	19.4%	18.7%	17.5%	18.7%	11.6%	16.2%	16.9%	14.5%	15.1%
営業利益	12,984	16,407	15,527	11,146	56,064	3,990	9,383	10,689	6,683	30,745
営業利益率	23.2%	25.5%	23.8%	18.6%	22.8%	12.2%	20.9%	19.8%	13.6%	17.0%
税引前当期(四半期)利益	12,901	16,429	15,667	10,898	55,895	3,727	9,145	10,742	6,143	29,757
税引前当期(四半期)利益率	23.0%	25.5%	24.0%	18.1%	22.7%	11.4%	20.3%	19.9%	12.5%	16.5%
当期(四半期)利益	9,605	11,297	11,064	8,339	40,305	2,655	6,158	7,914	5,647	22,374
当期(四半期)利益率	17.1%	17.5%	17.0%	13.9%	16.4%	8.1%	13.7%	14.7%	11.5%	12.4%
研究開発費	2,688	3,293	2,912	3,532	12,425	2,932	3,023	3,062	3,666	12,683
設備投資	736	2,853	2,151	828	6,568	5,077	2,071	10,478	2,828	20,454
減価償却費	2,529	2,563	2,600	2,612	10,304	2,637	2,671	2,792	2,845	10,945

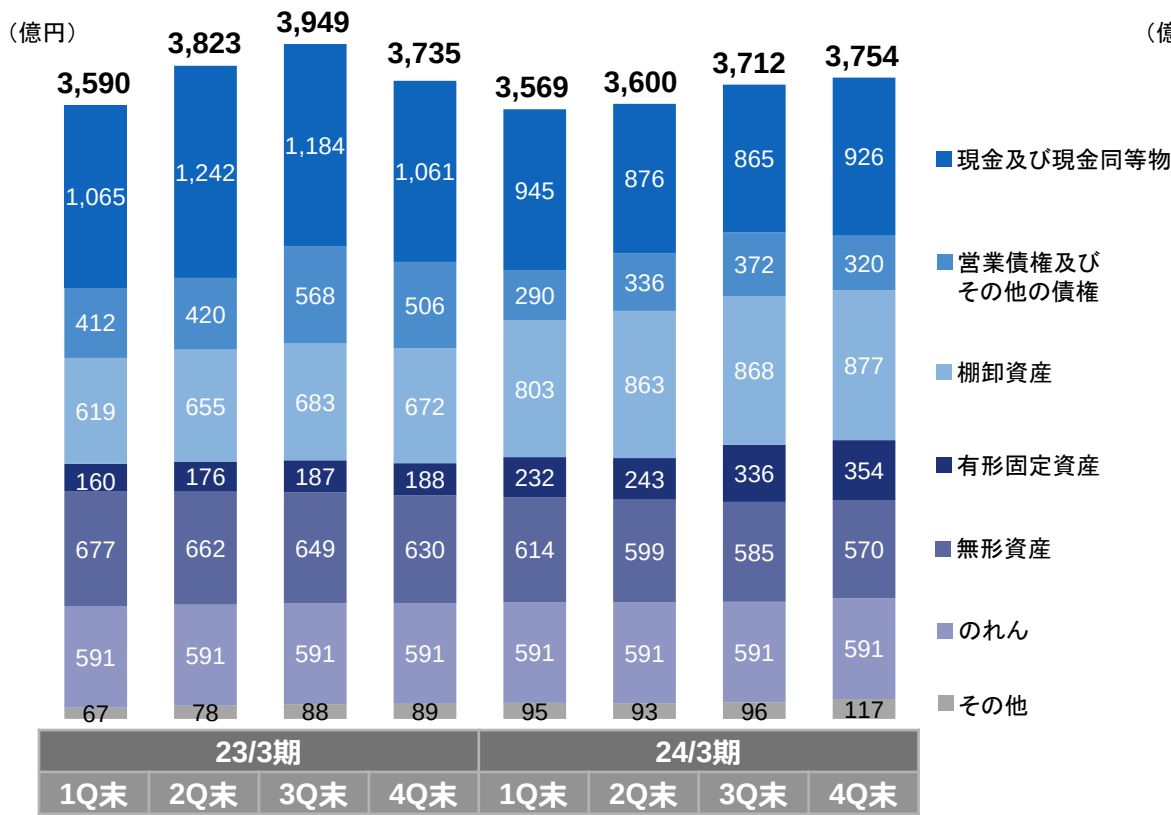
調整後利益等の計算における調整項目

(百万円)	23/3期					24/3期				
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期
営業利益	12,984	16,407	15,527	11,146	56,064	3,990	9,383	10,689	6,683	30,745
－その他の収益	△30	△30	△191	△19	△270	△30	△110	△285	△254	△679
＋その他の費用	23	88	41	1,410	1,562	45	33	19	390	487
(調整額)										
＋企業結合により識別した無形資産等の償却	1,592	1,593	1,592	1,592	6,369	1,592	1,592	1,593	1,592	6,369
＋スタンドアローン関連費用	105	16	156	76	353	1	10	203	9	223
＋株式報酬費用(業績連動型株式報酬制度に係るものを除く)	26	28	29	90	173	16	127	181	370	694
調整額 計	1,723	1,637	1,777	1,758	6,895	1,609	1,729	1,977	1,971	7,286
調整後営業利益	14,700	18,102	17,154	14,295	64,251	5,614	11,035	12,400	8,790	37,839
当期(四半期)利益	9,605	11,297	11,064	8,339	40,305	2,655	6,158	7,914	5,647	22,374
－その他の収益	△30	△30	△191	△19	△270	△30	△110	△285	△254	△679
＋その他の費用	23	88	41	1,410	1,562	45	33	19	390	487
(調整額)										
＋企業結合により識別した無形資産等の償却	1,592	1,593	1,592	1,592	6,369	1,592	1,592	1,593	1,592	6,369
＋スタンドアローン関連費用	105	16	156	76	353	1	10	203	9	223
＋株式報酬費用(業績連動型株式報酬制度に係るものを除く)	26	28	29	90	173	16	127	181	370	694
－調整項目に対する税金調整額	△525	△519	△498	△965	△2,507	△497	△506	△524	△645	△2,172
調整後当期(四半期)利益	10,796	12,473	12,193	10,523	45,985	3,782	7,304	9,101	7,109	27,296

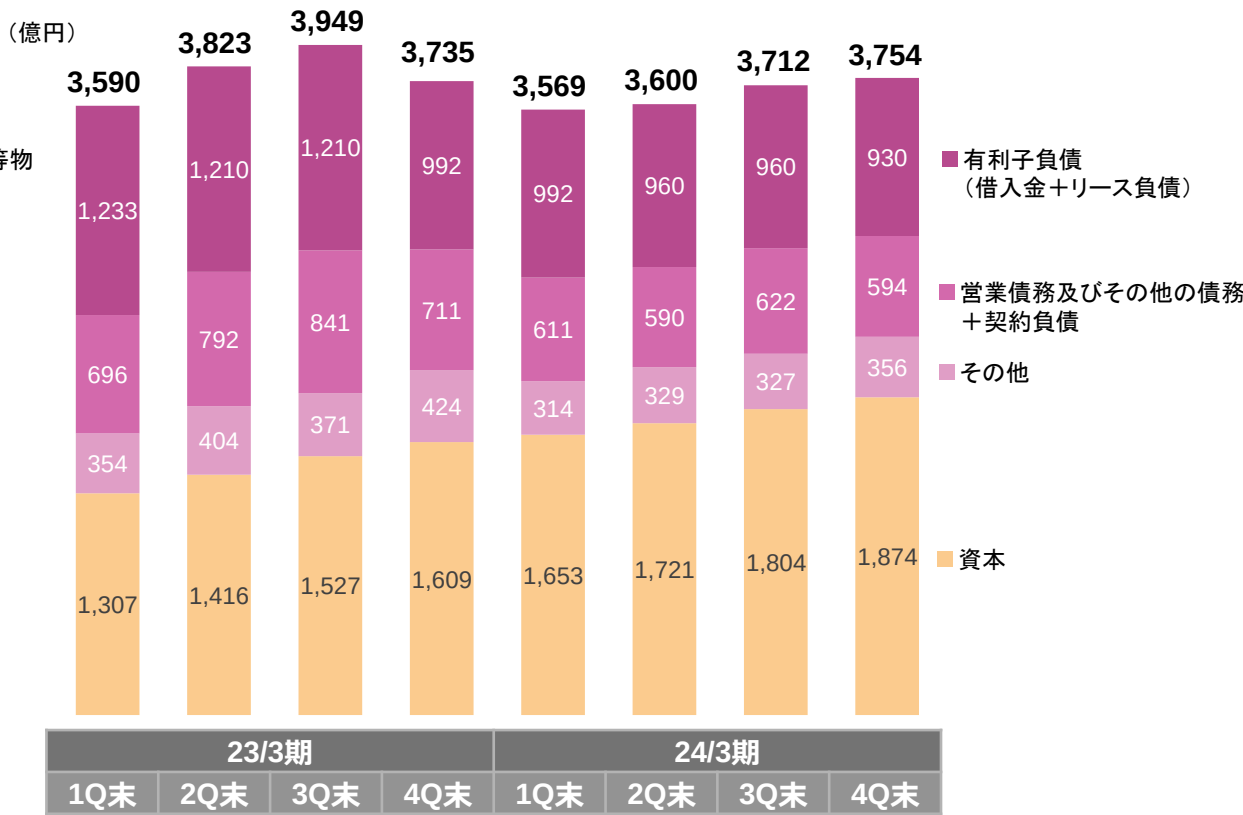
貸借対照表 四半期別

資産は棚卸資産、有形固定資産が増加傾向。
負債は有利子負債が減少。資本は利益剰余金が増加。

資産



負債・資本



貸借対照表及び主要財務指標

		21/3期		22/3期		23/3期		24/3期				21/3期		22/3期		23/3期		24/3期	
(百万円)		4Q末		4Q末		4Q末		4Q末		(百万円)		4Q末		4Q末		4Q末		4Q末	
資産	流動資産	現金及び現金同等物	40,039	108,399	106,053	92,619	負債	流動負債	借入金＋リース負債	3,343	4,968	6,596	8,019						
		営業債権及びその他の債権	41,732	45,973	50,617	31,994			営業債務及びその他の債務	46,426	49,901	41,790	36,667						
		棚卸資産	38,659	51,649	67,197	87,682			契約負債	4,000	18,760	29,283	22,719						
		その他	311	478	2,053	2,619			その他	11,972	24,904	23,784	20,138						
		流動資産合計	120,741	206,499	225,920	214,914			流動負債合計	65,741	98,533	101,453	87,543						
	非流動資産	有形固定資産	16,172	15,998	18,775	35,382		負債合計	非流動負債	借入金＋リース負債	122,417	118,223	92,610	84,999					
		のれん	59,065	59,065	59,065	59,065				その他	20,668	20,257	18,595	15,503					
		無形資産	75,075	69,049	62,968	56,995				非流動負債合計	143,085	138,480	111,205	100,502					
		その他	2,716	5,921	6,811	9,077			資本合計	64,943	119,519	160,881	187,388						
		非流動資産合計	153,028	150,033	147,619	160,519		負債及び資本合計		273,769	356,532	373,539	375,433						
資産合計		273,769	356,532	373,539	375,433														

	21/3期	22/3期	23/3期	24/3期
	4Q末	4Q末	4Q末	4Q末
自己資本比率	23.7%	33.5%	43.1%	49.9%
D/Eレシオ	1.9	1.0	0.6	0.5
ネット・キャッシュ(百万円)	△ 85,721	△ 14,792	6,847	△ 399

キャッシュ・フロー計算書 四半期別

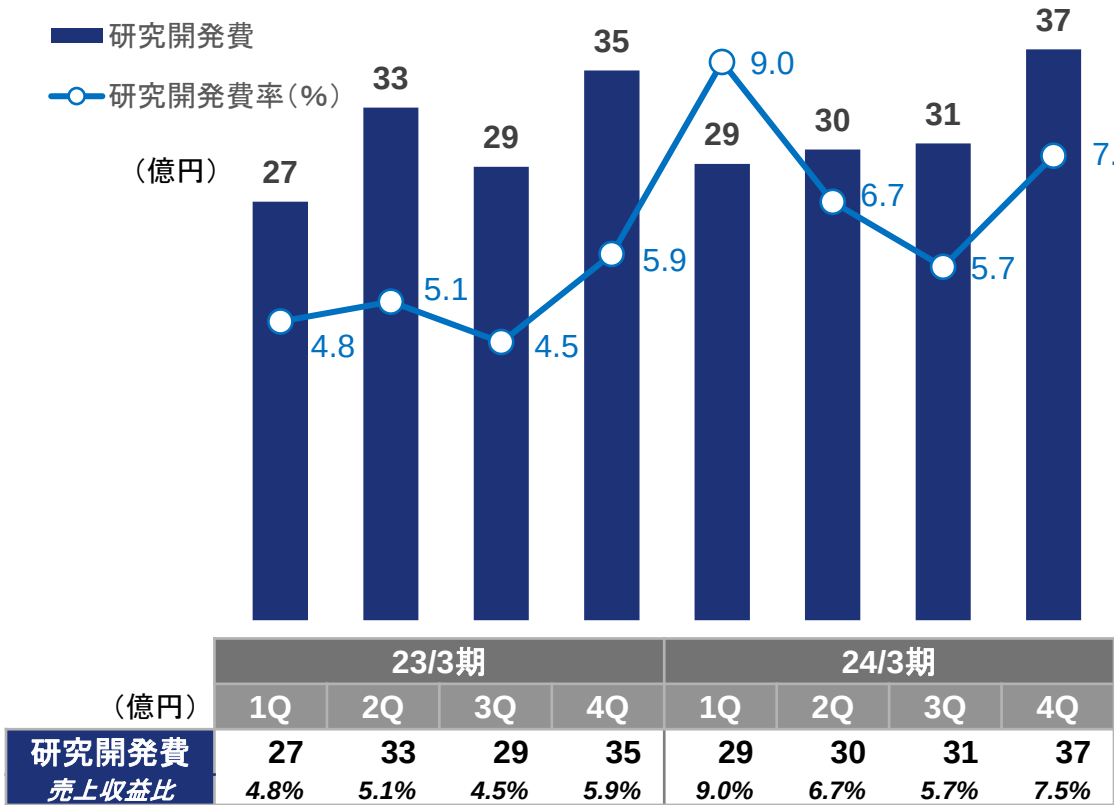
(百万円)

	23/3期					24/3期				
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,950	22,120	△ 3,351	13,174	29,993	△ 7,365	△ 2,030	2,443	9,894	2,942
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 982	△ 1,657	△ 2,069	△ 3,117	△ 7,825	△ 5,278	△ 2,037	△ 3,321	△ 1,314	△ 11,950
フリー・キャッシュ・フロー	△ 2,932	20,463	△ 5,420	10,057	22,168	△ 12,643	△ 4,067	△ 878	8,580	△ 9,008
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 120	△ 2,425	△ 163	△ 22,405	△ 25,113	△ 167	△ 3,171	70	△ 3,044	△ 6,312
現金及び現金同等物の期首残高	108,399	106,464	124,198	118,403	108,399	106,053	94,493	87,550	86,498	106,053
現金及び現金同等物の四半期末残高	106,464	124,198	118,403	106,053	106,053	94,493	87,550	86,498	92,619	92,619

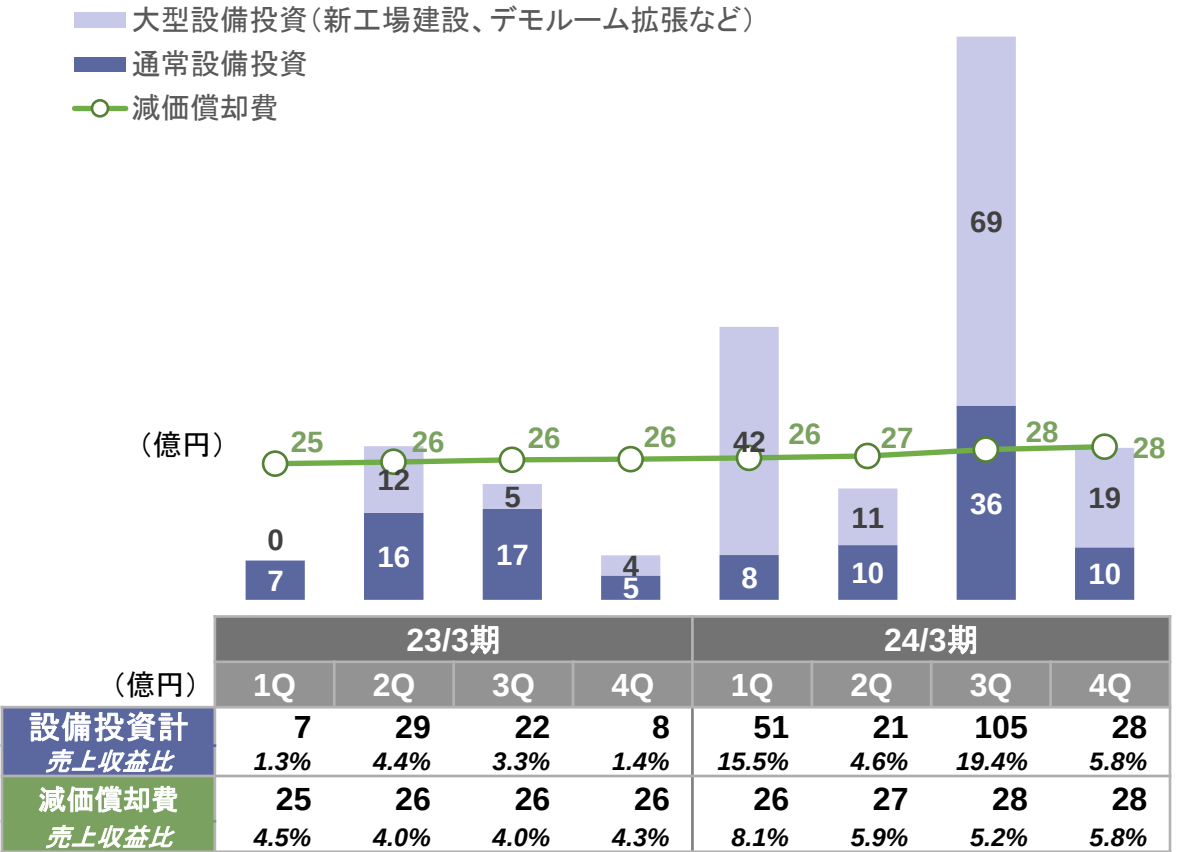
研究開発費／設備投資／減価償却費 四半期別

次世代製品開発に向けた投資を継続し、研究開発費比率は一時的に増加。売上回復に伴って平常化へ。
新工場建設やデモルーム拡張など長期償却の大型設備投資が増加。

研究開発費



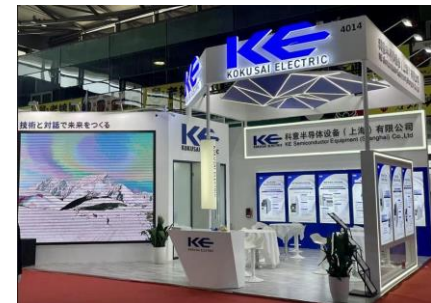
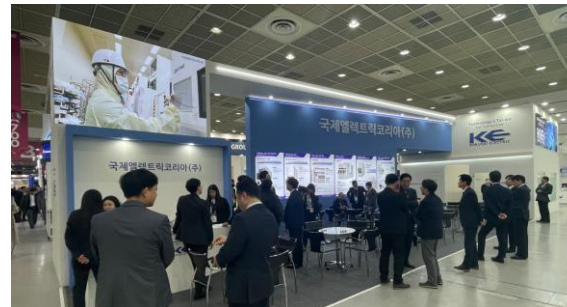
設備投資／減価償却費



2024年3月期の主な活動報告

事業活動

- Intel Corporationより2024 EPIC Distinguished Supplier Awardを受賞。(24/3)
- 次世代半導体関連の要素技術の研究開発に向けて横浜市に事務所を設置、2024年度末から本格稼働を予定。(24/1)
- 各地域で開催された半導体業界の展示会「SEMICON® CHINA」(24/3)、「SEMICON® KOREA」(24/1)、「SEMICON® Japan」(23/12)、「SEMICON® Europa 2023」(23/11)、「SEMICON® Taiwan 2023」(23/9)、「SEMICON® West 2023」(23/7)及び「SEMICON® China 2023」(23/6)に出展。
- 韓国生産拠点デモ評価エリアの竣工式を実施。(23/11)
- 当社が参画する「集積Green-niX研究・人材育成拠点」が 文部科学省「次世代X-nics半導体創生拠点形成事業」に採択。(23/7)
- Intel Corporationより2023 EPIC Distinguished Supplier Awardを受賞。(23/6)
- TechInsightsの顧客満足度調査で「10 BEST Suppliers」を26年連続受賞、また製品の種類別に優れた半導体製造装置サプライヤーを表彰する「THE BEST Suppliers」を受賞。(23/5)



2024年3月期の主な活動報告

ESGの取り組み

- 健康経営優良法人2024(大規模法人部門)に3年連続で認定。(24/3)
- プロサッカークラブ「カターレ富山」とオフィシャルパートナー契約を締結、6年連続のサポート。(24/2)
- 富山事業所がRBA VAP監査でシルバー・ステータスを取得。(24/1)
- 富山事業所で再生可能エネルギー「とやま水の郷でんき」の使用量を全体の20パーセントに引き上げ。(24/1)
- 日経ヴェリタス「ディール・オブ・ザ・イヤー2023」のIPO部門でベストディールに選出。(24/1)
- KOKUSAI ELECTRICグループ サステナブル調達ガイドラインの制定、サプライヤーへの周知・説明。(23/10)
- 富山事業所が拠点を構える富山市八尾地区で開催される行事「おわら風の盆」に協賛。(23/9)
- 子育てサポート企業として厚生労働大臣が認定する「くるみん認定」を取得。(23/7)
- 地域貢献活動の一環として保育所施設で青空環境教室を実施。(23/6)
- 当社サプライチェーンにおけるコンプライアンス強化を目的として、「コンプライアンス通報制度」を拡充。(23/6)
- 女性の活躍推進に積極的に取り組む企業の行動原則を示した、女性のエンパワメント原則(WEPPs)に署名。(23/4)



